

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-313250

(43)Date of publication of application : 09.11.2001

(51)Int.Cl.
H01L 21 027
G02B 19 00
G03F 7 22

(21)Application number : 2001-038326 (71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 15.02.2001 (72)Inventor : NISHINAGA HISASHI

(30)Priority

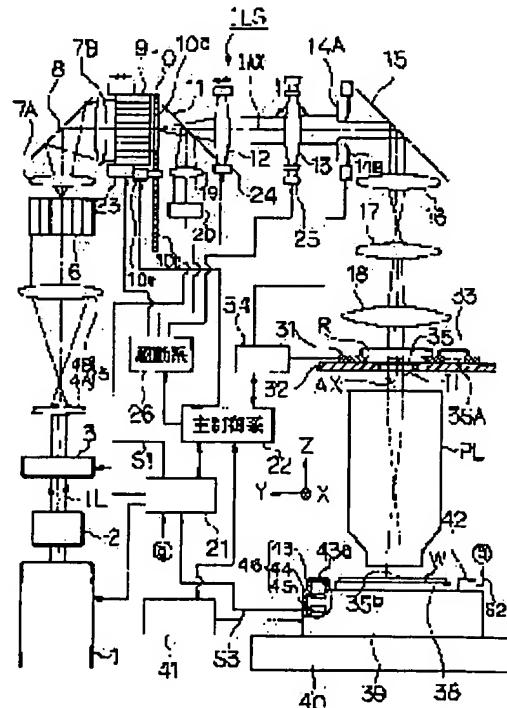
Priority number : 2000049740 Priority date : 25.02.2000 Priority country : JP

(54) ALIGNER, ITS ADJUSTING METHOD, AND METHOD FOR FABRICATING DEVICE USING ALIGNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aligner in which an illumination optical system can be adjusted accurately in a short time.

SOLUTION: A reticle R is irradiated with an exposing light IL from an exposing light source 1 through an illumination optical system ILS comprising a first fly eye lens 6, a second fly eye lens 9, lens systems 12, 13 blinds 14A, 14B, and condenser lens systems 17, 18 and the pattern image of the reticle R is projected onto a wafer W through a projection optical system PL. Specific illumination characteristics are measured using an evaluation mark plate 33 on a reticle stage 31, and a spatial image measuring system 46 provided on a wafer stage 39 and then the state of the second fly eye lens 9 and the lens systems 12, 13 is adjusted through drive units 23, 24 and 25 based on the measurements.



* NOTICES

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] An exposure device which is provided with an illumination system which illuminates the 1st object by an exposure beam, and exposes the 2nd object via said 1st object by said exposure beam, comprising:

A lighting condition change system which is arranged in said illumination system and switches lighting conditions of said exposure beam to any of two or more lighting conditions they are. A regulating system which adjusts a state of a predetermined optical member in said illumination system in order to control the predetermined lighting characteristic of said illumination system according to each of two or more of said lighting conditions.

[Claim 2] The exposure device according to claim 1, wherein said lighting characteristic is either [at least] illumination unevenness of said exposure beam, or the amount of collapse of the tele centric nature of said exposure beam.

[Claim 3] The exposure device according to claim 2, wherein said lighting characteristics are slant components of illumination unevenness of said exposure beam, a concavo-convex ingredient, slant components of the amount of collapse of the tele centric nature of said exposure beam, and magnification components.

[Claim 4] Claims 1 and 2 characterized by comprising the following, or an exposure device given in 3.

A characteristic measurement system which measures said lighting characteristic of said illumination system.

An arithmetic control system memorized in quest of relation between drive quantity of said regulating system, and variation of said lighting characteristic based on a measuring result of this characteristic measurement system.

[Claim 5 An exposure device which is provided with an illumination system which illuminates the 1st object by an exposure beam, and exposes the 2nd object via said 1st object by said exposure beam, comprising:

A characteristic measurement system which measures the predetermined lighting characteristic of said illumination system.

A regulating system which adjusts a state of a predetermined optical member in said illumination system according to a measuring result of this characteristic measurement system.

[Claim 6 The exposure device according to any one of claims 1 to 5, wherein said illumination system has an optical integrator and said regulating system adjusts a position of an optical axis direction of said optical integrator.

[Claim 7 Said illumination system said exposure beam which passed said optical integrator An irradiated plane of said 1st object, Or have further the 1st optical system led to this and a conjugate field, and the 2nd optical system, and said regulating system, The exposure device according to claim 6 adjusting a position of an optical axis direction of said optical integrator, a position of an optical axis direction of said 1st optical system, a position of a direction vertical to an optic axis of said 2nd optical system, and a tilt angle.

[Claim 8 The exposure device according to any one of claims 1 to 7 which is provided with the following and characterized by said regulating system adjusting a state of an optical member which constitutes said condensing optical system.

An optical element for said illumination system to set illuminance distribution of said exposure beam as a local field for deformation illuminations.

A condensing optical system which draws an exposure beam from this optical element.

An optical integrator for equalizing illuminance distribution of an exposure beam from this condensing optical system.

[Claim 9 Said illumination system is provided with a beam forming optical system which fabricates an exposure beam from an exposure light source, and is led to said optical element, The exposure device according to claim 8 adjusting a state of said beam forming optical system with said regulating system so that a size of illumination of said exposure beam and a size of dispersion in illuminance distribution of said exposure beam can be balanced.

[Claim 10 An exposure device dividing the amount of collapse of the tele centric nature of said exposure beam in said illumination system into slant components and magnification components, and measuring it in an exposure device which is provided with an illumination system which illuminates the 1st object by an exposure beam, and exposes the 2nd object via said 1st object by said exposure beam.

[Claim 11 The exposure device according to claim 10 dividing illumination unevenness of said

exposure beam by said illumination system into slant components and a concavo-convex ingredient, and measuring it.

[Claim 12] The exposure device according to any one of claims 1 to 11 which is provided with the following, is further provided with a drive system which carries out the synchronous drive of said 1st and 2nd movable bodies, and is characterized by carrying out scanning exposure of said 2nd object by said exposure beam via said 1st object.

The 1st movable body in which said 1st object is laid.

The 2nd movable body in which said 2nd object is laid.

[Claim 13] The exposure device according to claim 12 measuring slant components of illumination unevenness about a non-scanning direction which intersects perpendicularly with a scanning direction which detects said exposure beam on a predetermined side where said 2nd object is arranged, and to which said 1st and 2nd objects are moved in an irradiation area of said exposure beam at the time of said scanning exposure.

[Claim 14] The exposure device according to claim 13 characterized by determining a concavo-convex ingredient of said illumination unevenness, and slant components about said non-scanning direction based on cumulative size distribution about said non-scanning direction acquired by integrating illumination or light volume about said scanning direction in an irradiation area of said exposure beam.

[Claim 15] Claims 12 and 13 detecting an exposure beam irradiated by mark provided on said 1st movable body in addition to said 1st object, and measuring the amount of collapse, or an exposure device given in 14.

[Claim 16] An adjustment method of an exposure device which irradiates the 1st object with an exposure beam which passes along an illumination system, and exposes the 2nd object by said exposure beam via said 1st object characterized by comprising the following.

Said exposure beam is detected on a predetermined side where said 2nd object is arranged, and it is the telecentricity of said illumination system.

distribution of illumination in an irradiation area of said exposure beam, or light volume -- at least -- on the other hand.

[Claim 17] The synchronous drive of the 1st movable body in which said 1st object is laid, and the 2nd movable body in which said 2nd object is laid is carried out, An adjustment method of the exposure device according to claim 16 measuring said lighting characteristic using a mark which carries out scanning exposure of said 2nd object by said exposure beam via said 1st object, and is provided on said 1st movable body in addition to said 1st object.

[Claim 18] Said exposure beam is detected on a predetermined side where said 2nd object is arranged, An adjustment method of the exposure device according to claim 17 measuring slant

components of illumination unevenness about a non-scanning direction which intersects perpendicularly with a scanning direction to which said 1st and 2nd objects are moved in an irradiation area of said exposure beam at the time of said scanning exposure.

[Claim 19 In an adjustment method of an exposure device which is provided with an illumination system which illuminates the 1st object by an exposure beam, and exposes the 2nd object via said 1st object by said exposure beam, Set a state of a predetermined optical member in said illumination system as two or more states, and the predetermined lighting characteristic of said illumination system is measured, respectively, An adjustment method of an exposure device memorizing in quest of relation between drive quantity of said optical member, and variation of said lighting characteristic, and driving said optical member based on a memorized this relation based on this measuring result in order to control said lighting characteristic.

[Claim 20 A change of lighting conditions of said illumination system is enabled they to be any of two or more lighting conditions], An adjustment method of the exposure device according to claim 19 setting it as an optimal position to lighting conditions after switching a position of said optical member when it memorizes in quest of an optimal position of said optical member to each of two or more of said lighting conditions and lighting conditions of said illumination system are switched.

[Claim 21 A device manufacturing method including a process of transferring a device pattern on a work piece using the exposure device according to any one of claims 1 to 15.

[Translation done.]

*** NOTICES**

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention**[0001]**

[Field of the Invention] This invention, for example A semiconductor device, a liquid crystal display element, a plasma display element, Or it is related with the exposure device provided with the function to adjust especially an illumination system automatically, about the exposure device used in order to transfer a mask pattern on a substrate via a projection optical system by the lithography process for manufacturing a thin film magnetic head etc., and the adjustment method of this exposure device.

[0002]

[Description of the Prior Art] The lithography process for manufacturing a semiconductor device, in order to correspond to improvement in the degree of location of a semiconductor device, and the degree of detail (typically as resist application Takumi) from an exposure process and a resist developing process -- becoming -- in the exposure device to bear, it is demanded of raising resolution, transfer fidelity, etc. more. Thus, it is necessary to carry out short wavelength formation of the wavelength of the exposing light as an exposure beam, to use a projection optical system with a large numerical aperture, in order to raise resolution and transfer fidelity, and to perform light exposure control for exposing the photoresist applied on the wafer as a substrate in the amount of appropriate exposure with high precision. And in order to pull out the imaging characteristic of the projection optical system to a limit and to perform light exposure control of photoresist with high precision, it is necessary to optimize the illumination-light study system so that the lighting characteristic of an illumination-light study system which illuminates the reticle as a mask by exposing light may be improved as much as possible.

[0003] Adjustment for optimizing the illumination-light study system of an exposure device was conventionally performed at the following processes.

(**) An operator measures the lighting characteristic (for example, illumination unevenness) of the adjustment object of an illumination-light study system.

(**) Adjust the states (a position or an angle of inclination) of a predetermined optical member using the drive unit corresponding to the lighting characteristic based on the measuring result.

The drive quantity in this case is set up by correcting an optical design value based on experience of an operator improve that lighting characteristic as much as possible.

[0004](**) After the adjustment, when the quantity in which the lighting characteristic remains is re-measured and the quantity which remains exceeds tolerance level, readjust via the drive unit.

(**) Memorize the final state (optimal state) of the optical member after completion of the adjustment.

And in each of two or more lighting conditions, when a state with optimal optical member that repeats the above-mentioned adjusting process for every lighting characteristic of an adjustment object, and corresponds was memorized and lighting conditions were switched, the corresponding optical member was set as the respectively optimal state.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Adjustment for optimizing the illumination-light study system of the conventional exposure device was performed by the operator like the above at the time of rigging of an exposure device, and a maintenance, etc. However, when an operator adjusts, there is inconvenience that adjustment takes long time. Since it was necessary to adjust an illumination-light study system about two or more lighting conditions of all, respectively, the whole adjusting time was quite long. Since the time which optimization takes was influenced by the level of skill of an operator, it also had a possibility that adjusting time might become long further depending on an operator.

[0006]Since it was necessary to take into consideration the influence of mutual accompanying adjustment, etc. when the state of two or more optical members in an illumination-light study system needs to be adjusted, the adjusting process was very complicated. Thus, since adjustment of the conventional illumination-light study system took the complicated prolonged process, it was difficult to perform employment to which the permissible level of a predetermined lighting characteristic is changed according to the precision prescribe etc. of the device manufactured, for example. For example, although illumination unevenness in a lighting characteristic may change with the cloudy weather of the optical member in an illumination-light study system, degradation of ** material, etc. temporally, it was difficult to correspond promptly by the conventional adjustment method also in such a case.

[0007]This invention sets it as the 1st purpose to provide the exposure device which can adjust an illumination-light study system in a short time correctly in view of this point. This invention sets it as the 2nd purpose to provide the exposure device which can adjust substantially the

illumination-light study system which can be switched to two or more lighting conditions automatically.

[0008]An object of this invention is also to provide the efficient directions for such an exposure device, and the highly precise device manufacturing method using the exposure device.

[0009]

[Means for Solving the Problem] The 1st exposure device of this invention is provided with an illumination system (ILS) which illuminates the 1st object (R) by an exposure beam, and is characterized by that an exposure device which exposes the 2nd object (W) via the 1st object by the exposure beam comprises the following.

A lighting condition change system which is arranged in the illumination system and switches lighting conditions of the exposure beam to any of two or more lighting conditions they are (10, 10e).

A regulating system which adjusts a state of a predetermined optical member (9, 12, 13) in the illumination system in order to control the predetermined lighting characteristic of the illumination system according to each of two or more of the lighting conditions (23, 24, 25).

[0010]According to this this invention, when lighting conditions are switched by the lighting condition change system, according to lighting conditions after a change, states (a position of an optical axis direction, a position of a direction vertical to an optic axis, a tilt angle, etc.) of the optical member are adjusted via the regulating system. The predetermined lighting characteristic of an illumination system is automatically controllable by this in the desired state respectively substantially to two or more lighting conditions.

[0011]In this case, an example of the predetermined lighting characteristic of that evaluation object is either at least illumination unevenness of that exposure beam, or the amount of collapse of the tele centric nature of that exposure beam. These are the very important characteristics, in order to obtain high resolution on [both] the 2nd object. It is desirable to use the lighting characteristic of the evaluation object as slant components of illumination unevenness of the exposure beam, a concavo-convex ingredient, slant components (two-dimensional vector quantity) of the amount of collapse of the tele centric nature of the exposure beam, and magnification components. Since an ingredient of these five lighting characteristics can be controlled easy almost independently by driving two or more optical members in that illumination system mutually-independent, it is easily automatable especially.

[0012]Here, the amount of collapse of the tele centric nature of an exposure beam is the telecentricity of an illumination system (or illumination-light study system). It is desirable to have an arithmetic control system (22) memorized in quest of a relation of drive quantity and variation of a lighting characteristic of that regulating system based on a measuring result of a characteristic measurement system (33, 46, 42) which measures that lighting characteristic of

that illumination system, and this characteristic measurement system. . When the lighting characteristic changes temporally, measure the lighting characteristic, for example by the characteristic measurement system periodically. or a relation memorized previously is updated by calculation (simulation) -- or both -- using together (that is, the above-mentioned relation is updated by calculation between measurement of a periodical lighting characteristic). By driving the regulating system based on this, the lighting characteristic can be promptly returned to a desired state.

[0013]Next, the 2nd exposure device of this invention is provided with an illumination system (ILS) which illuminates the 1st object (R) by an exposure beam, and is characterized by that an exposure device which exposes the 2nd object (W) via the 1st object by the exposure beam comprises the following.

A characteristic measurement system which measures the predetermined lighting characteristic of the illumination system (33, 46, 42).

A regulating system which adjusts a state of a predetermined optical member in that illumination system according to a measuring result of this characteristic measurement system (23, 24, 25).

[0014]According to this this invention, the illumination system can be correctly adjusted in a short time by driving the regulating system based on a measuring result of the characteristic measurement system provided with a space image measurement system etc., for example. The illumination system in these this inventions An optical integrator (9), and (a YUNIFO mizer or a homogenizer), The exposure beam which passed the optical integrator An irradiated plane of the 1st object, Or when it has the 1st optical system (12) led to this and a conjugate field, and the 2nd optical system (13), the following lighting characteristics can be substantially controlled by adjusting a state of these optical members as follows mutually-independent, respectively.

[0015](a1) Justification of an optical axis direction of an optical integrator (9) : Magnification components of the amount of collapse of the tele centric nature of an exposure beam, (b1) Justification of an optical axis direction of the 1st optical system : Slant components of the amount of collapse of the tele centric nature of a two-dimensional justification:exposure beam of a direction vertical to a concavo-convex ingredient of illumination unevenness, and an optic axis of the 2nd (c1) optical system (two-dimensional vector quantity), A tilt angle of the 2nd optical system: (d1) Slant components of the direction of illumination unevenness which carries out a tilt. As for the direction which carries out a tilt, in the case of an exposure device of a scanning exposure manner, it is desirable to deal with a non-scanning direction which intersects perpendicularly with a scanning direction. This is because the equalization effect does not arise to illumination unevenness being equalized in a non-scanning direction

according to the storage effect, so amending by the tilt is desirable in a scanning direction.

[0016]An optical element (55) for the illumination system to set illuminance distribution of the exposure beam as a local field for deformation illuminations in above-mentioned this invention, A beam forming optical system (5) which leads an exposure beam from an exposure light source to the optical element, A condensing optical system (7A, 7B) which draws an exposure beam from the optical element (55), As for that regulating system, when it has an optical integrator (9) (a YUNIFO mizer or a homogenizer) for equalizing illuminance distribution of an exposure beam from this condensing optical system, it is desirable to adjust a state of that condensing optical system or its beam forming optical system.

[0017]In this case, illumination unevenness can be made small, after making a loss of an exposure beam into the minimum by adjusting that beam forming optical system so that a size of illumination of that exposure beam and a size of dispersion in illuminance distribution of that exposure beam can be balanced, for example. In an exposure device which the 3rd exposure device of this invention is provided with an illumination system (ILS) which illuminates the 1st object (R) by an exposure beam, and exposes the 2nd object (W) via the 1st object by the exposure beam, The amount of collapse of the tele centric nature of the exposure beam in the illumination system is divided into slant components and magnification components, and is measured. Thus, by dividing into slant components and magnification components, it can adjust easily almost mutually-independent.

[0018]The 1st movable body (31) in which the 1st object is laid in an exposure device of above-mentioned this invention, The 2nd object has the 2nd movable body (39) laid, is further provided with a drive system (34, 41) which carries out the synchronous drive of the 1st and 2nd movable bodies, and may be made to carry out scanning exposure of the 2nd object by the exposure beam via the 1st object. In this case, it is desirable to measure slant components of illumination unevenness about a non-scanning direction which intersects perpendicularly with a scanning direction which detects that exposure beam on a predetermined side where that 2nd object is arranged, and to which those 1st and 2nd objects are moved in an irradiation area of that exposure beam at the time of that scanning exposure. When performing scanning exposure, since illumination unevenness of a scanning direction is reduced by the equalization effect, it is measuring illumination unevenness of a non-scanning direction, and can simplify a metering device.

[0019]An exposure beam irradiated by mark (36A) provided on the 1st movable body in addition to the 1st object is detected, and it may be made to measure the amount of collapse. A lighting characteristic can be measured if needed by this, without depending on a pattern of the 1st object (mask etc.). Next, an adjustment method of the 1st exposure device of this invention, In an adjustment method of an exposure device which irradiates the 1st object (R) with an exposure beam which passes along an illumination system (ILS), and exposes the 2nd

object (W) by the exposure beam via the 1st object, Measure a lighting characteristic which detects the exposure beam on a predetermined side where the 2nd object is arranged, and contains at least one side of telecentricity of the illumination system, and distribution of illumination in an irradiation area of the exposure beam, or light volume, and. The measured lighting characteristic is updated by calculation until it drives an optical member (9, 12, 13) within the illumination system based on the measured lighting characteristic and measures the lighting characteristic next, and the optical member is driven based on the updated lighting characteristic.

[0020]According to this this invention, measurement frequency of the lighting characteristic is lessened and the lighting characteristic of the illumination system can be adjusted in a short time with high precision. In this case, the synchronous drive of the 1st movable body (31) in which that 1st object is laid, and the 2nd movable body (39) in which that 2nd object is laid is carried out, It may be made to measure the lighting characteristic using a mark (36A) which carries out scanning exposure of the 2nd object by the exposure beam via the 1st object, and is provided on the 1st movable body in addition to the 1st object.

[0021]It may be made to measure slant components of illumination unevenness about a non-scanning direction which intersects perpendicularly with a scanning direction which detects the exposure beam on a predetermined side where the 2nd object is arranged, and to which the 1st and 2nd objects are moved in an irradiation area of the exposure beam at the time of the scanning exposure. Illumination unevenness of a scanning direction is measuring an ingredient of a non-scanning direction, since it decreases by the equalization effect, in the case of a scanning exposure manner, simplifies a measurement step, and can measure a required lighting characteristic efficiently in it.

[0022]Next, an adjustment method of the 2nd exposure device of this invention, In an adjustment method of an exposure device which is provided with an illumination system (ILS) which illuminates the 1st object by an exposure beam, and exposes the 2nd object via the 1st object by the exposure beam, A state of a predetermined optical member (9, 12, 13) in the illumination system is set as two or more states, The predetermined lighting characteristic of that illumination system is measured, respectively, and it memorizes in quest of relations (ratio etc.) of drive quantity and variation of a lighting characteristic of that optical member based on this measuring result, and based on this memorized relation, in order to control that lighting characteristic, that optical member is driven. According to this invention, a lighting characteristic can be efficiently adjusted by asking for a relation of drive quantity and variation of a lighting characteristic of the optical member beforehand.

[0023]A device manufacturing method of this invention includes a process of transferring a device pattern (R) on a work piece (W) using an exposure device of this invention. A device with a high degree of location can be mass-produced with high precision by this invention.

[0024]

[Embodiment of the Invention Hereafter, with reference to drawings, it explains per example of an embodiment of the invention. This example applies this invention to the scanning exposure type projection aligner of a step and scanning method or a step and SUTITCHI method.

Drawing 1 shows the outline composition of the projection aligner of this example, and the source of ArF excimer laser light (wavelength of 193 nm) is used as the exposure light source 1 in this drawing 1. However, as the exposure light source 1, a KrF excimer laser (wavelength of 248 nm), F₂ laser (wavelength of 157 nm), Kr₂ laser (wavelength of 146 nm), the harmonic generation device of an YAG laser, the harmonic generation device of a semiconductor laser, or a mercury lamp can be used. Exposing light IL (exposure beam) which consists of ultraviolet pulsed light with a wavelength from the exposure light source 1 of 193 nm passes along the beam matching unit (BMU) 2 for making an optical path match in position between the main parts of an exposure device, and enters into the variable beam attenuator 3 as an optical attenuator. The exposure control unit 21 for controlling the light exposure to the photoresist on a wafer controls the start, stop, and output (oscillating frequency, pulse energy) of luminescence of the exposure light source 1, and the fading rate in the variable beam attenuator 3 is adjusted gradually or continuously.

[0025]Exposing light IL which passed along the variable beam attenuator 3 enters into the 1st fly eye lens 6 as an optical integrator (a YUNIFO mizer or a homogenizer) of the 1st step through the beam shaping system 5 which consists of the 1st lens system 4A and the 2nd lens system 4B which are arranged in accordance with a predetermined optic axis. Exposing light IL ejected from this 1st fly eye lens 6 enters into the 2nd fly eye lens 9 as an optical integrator of the 2nd step via the 1st lens system 7A, the mirror 8 for optical-path bending, and the 2nd lens system 7B. The relay optical system (or it can also be called a beam shaping system) as a condensing optical system comprises the 1st lens system 7A and the 2nd lens system 7B.

[0026]The aperture-diaphragm board 10 is arranged by the drive motor 10e at the optical Fourier transformation plane (pupil surface of an illumination system) to the projection surface of the 2nd fly eye lens 9, i.e., the pattern surface side of the reticle R of an exposure object, (reticle side), enabling free rotation. As shown to drawing 6 (b) in a front view, to the aperture-diaphragm board 10 The aperture diaphragm 10a usually circular [for lighting], the aperture diaphragm 10b for the zona-orbicularis lighting as an example of deformation illumination, and the modification light source (or what is called oblique illumination) as another example of deformation illumination -- the aperture diaphragm 10c which consists of a small aperture in which the plurality (this example four pieces) of business carried out eccentricity. And 10 d of small aperture diaphragms of the small circle type for coherence factors (sigma value) are arranged, enabling a free change. The aperture diaphragm 10c can also be said to be the aperture diaphragm for 4 pole lighting. The "lighting condition change system" which switches

lighting conditions to any of two or more lighting conditions (usually lighting, deformation illumination, and small sigma value lighting) they are comprises the aperture-diaphragm board 10 and the drive motor 10e, and the main control system 22 which carries out control control of the operation of the whole device sets up lighting conditions via the drive motor 10e.

[0027]In drawing 1, the aperture diaphragm 10a for lighting is usually installed in the projection surface of the 2nd fly eye lens 9, and exposing light IL which was ejected from the 2nd fly eye lens 9, and passed the aperture diaphragm 10a enters into the beam splitter 11 with low reflectance with high transmissivity. The exposing light reflected by the beam splitter 11 enters into the integrator sensor 20 which consists of photoelectric detectors via the lens 19 for condensing, and the detecting signal S1 of the integrator sensor 20 is supplied to the exposure control unit 21. The relation between the detecting signal of the integrator sensor 20 and the illumination of exposing light IL on the wafer W as an exposed substrate is measured with high precision beforehand, and is memorized by the memory in the exposure control unit 21. The exposure control unit 21 is constituted so that the illumination (average value) of exposing light IL to the wafer W and its integral value can be monitored more nearly indirectly than the detecting signal of the integrator sensor 20.

[0028]exposing light IL which penetrated the beam splitter 11 should pass the 1st lens system 12 (the 1st optical system) and the 2nd lens system 13 (the 2nd optical system) in accordance with the optic axis IAX -- it enters into the fixed blind (fixed lighting field diaphragm) 14A and the movable blind (movable lighting field diaphragm) 14B one by one. The latter movable blind 14B is installed in the conjugate side over a reticle side, and the former fixed blind 14A is arranged in the field which defocused only the specified quantity from the conjugate side. The fixed blind 14A as indicated by JP,4-196513,A, for example, To the non-scanning direction (the direction of X) which intersects perpendicularly with the scanning direction (the direction of Y) which centers on the optic axis AX mostly within the circular view of projection optical system PL, and to which the reticle R and the wafer W are moved at the time of scanning exposure, straight-line slit shape, Or it has an opening arranged so that it may be extended to rectangular shape (collectively henceforth slit shape). Namely, the illuminated field 35 on the reticle R by which exposing light IL is irradiated with the fixed blind 14A by this example and the exposure region 35P (about projection optical system PL, it is the illuminated field 35 and conjugate and on the wafer W The projection area in which the pattern image in the illuminated field 35 is formed is specified, and the width about a scanning direction has at least the Sekiguchi part which is immobilization.

[0029]The movable blind 14B is used in order to make variable width of the scanning direction of the illuminated field 35 specified with the fixed blind 14A in order to prevent exposure unnecessary at the time of the start of the scanning exposure to each shot region on the wafer W, and an end, and the exposure region 35P. The movable blind 14B is used also in order to

make the width variable according to the size of the pattern space of the reticle R about the direction (non-scanning direction) which intersected perpendicularly with scanning direction SD further. The information on the numerical aperture of the movable blind 14B is supplied also to the exposure control unit 21, and the value which multiplied the illumination called for from the detecting signal of the integrator sensor 20 by the numerical aperture serves as actual illumination on the wafer W. The arrangement is not limited to drawing 1, between the reticle R and an illumination-light study system, the fixed blind 14A may be made to approach the reticle R, and the fixed blind 14A and the movable blind 14B may arrange it, for example.

[0030] Exposing light IL which passed the fixed blind 14A at the time of exposure, The illuminated field (lighting field field) 35 of the pattern surface side (undersurface) of the reticle R as a mask is illuminated via the mirror 15 for optical-path bending, the lens system 16 for image formation, the subcondenser lens system 17, and the main condenser lens system 18. the basis of exposing light IL -- the image of the circuit pattern in the illuminated field of the reticle R -- a both-sides call -- it being the predetermined projecting magnification beta (beta is 1/4, and 1 / 5 grades), and via centric projection optical system PL, It is transferred by the slit shape exposure region 35P of the photoresist layer on the wafer W as a substrate (exposed substrate) arranged in the image formation face of projection optical system PL. The reticle R and the wafer W are equivalent to the 1st object and the 2nd object of this invention, respectively, and wafer (wafer)W is disc-like substrates, such as semiconductors (silicon etc.) or SOI (silicon on insulator). Although projection optical system PL as a projection system of this example is a dioptric system (refractive media), it cannot be overemphasized that a catadioptric system (reflective refractive media) and a reflection system can also be used. The Z-axis is taken in parallel with the optic axis AX of projection optical system PL hereafter, a Y-axis is taken to a scanning direction (direction parallel to the space of drawing 1 here) in a flat surface vertical to the Z-axis, and the X-axis is taken and explained to the non-scanning direction (direction vertical to the space of drawing 1 here) which intersects perpendicularly with a scanning direction.

[0031] In drawing 1, the exposure light source 1, the beam matching unit 2, the variable beam attenuator 3, the beam shaping system 5, the 1st fly eye lens 6, the 1st lens system 7A, The 2nd lens system 7B, the 2nd fly eye lens 9, the 1st lens system 12, the 2nd lens system 13, the fixed blind 14A, Illumination-light study system ILS comprises the movable blind 14B, the imaging lens system 16, the subcondenser lens system 17, and main condenser lens system 18 grade, and illumination-light study system ILS supports the illumination system of this invention. And the optic axis IAX of illumination-light study system ILS has agreed with the optic axis AX of projection optical system PL on the reticle R. In this example, the 2nd fly eye lens 9, the 1st lens system 12, and the 2nd lens system 13 are equipped with the 1st drive unit 23, the 2nd drive unit 24, and the drive unit group 25, respectively.

[0032]In drawing 2 is a perspective view showing the optical system from the 2nd fly eye lens 9 of drawing 1 to the 2nd lens system 13, and a relation with the illuminated field 35, and] this drawing 2, The direction of [on the 2nd fly eye lens 9 corresponding to scanning direction SD (the direction of Y) and the non-scanning direction (the direction of X) of the reticle to the illuminated field 35] is made into the y direction and the x direction, respectively. And the 1st drive unit 23 adjusts the position of the optic-axis IAX direction (the direction of the arrow A1) of the 2nd fly eye lens 9, and the 2nd drive unit 24 adjusts the position of the direction of the optic axis IAX of the 1st lens system 12 (the direction of the arrow A2). The drive unit group 25 of drawing 1 The 3rd drive unit 25X of drawing 2, It comprises the 4th drive unit 25Y and the 5th drive unit 25T, The drive units 25X and 25Y adjust the position of a x direction (the direction of arrow A3) respectively vertical to the optic axis IAX of the 2nd lens system 13, and a y direction (the direction of arrow A4), The drive unit 25T adjusts the surrounding (the direction of arrow A5) tilt angle of an axis parallel to the y-axis through the optic axis IAX of the 2nd lens system 13. It can be said that the drive unit 25T adjusts the tilt angle (angle of inclination) of the 2nd lens system 13 a direction [corresponding to the non-scanning direction of the illuminated field 35].

[0033]As the drive units 23-25T, the drive which displaces the flange of the optical member for a drive, for example by driver elements, such as a micrometer of an electric type or a piezo-electric element, can be used. In this case, the encoders (rotary encoder etc.) (un-illustrating) which show the amount of displacement of the optical member in a driving feasible range (driving stroke) to the drive units 23-25T, respectively are incorporated, The detecting signal of these encoders is supplied to the drive system 26 of drawing 1, and the drive system 26 controls the state of the 2nd fly eye lens 9, the 1st lens system 12, and the 2nd lens system 13 via the drive units 23-25T based on the detecting signal and the drive information from the main control system 22. An electrostatic capacity sensor etc. may be used as the drive unit 23 - an encoder for 25T, for example.

[0034]When performing deformation illumination, as it is shown in drawing 6 (a), it comprises this example so that the 1st fly eye lens 6 can be exchanged using the swap device 56 by the luminous-energy-distribution sensing element 55 which consists of diffraction optical elements (Diffractive Optical Element:DOE). The luminous-energy-distribution sensing element 55 is equivalent to the optical element for setting an exposure beam as a local field.

[0035]In drawing 6 (a), in performing deformation illumination, The zona-orbicularis-like aperture diaphragm 10b (or 4 aperture diaphragm 10c very for lighting) is installed in the projection surface of the 2nd fly eye lens 9 as an example, and the luminous-energy-distribution sensing element 55 condenses exposing light IL according to the diffraction effect to the almost ring band-like field of the entrance plane of the 2nd fly eye lens 9. The luminous-energy-distribution sensing element 55 is also contained in illumination-light study system ILS.

Also when the utilization efficiency of exposing light IL is raised by this and it performs deformation illumination by it, high illumination is obtained on a wafer. In this case. The position of the optic-axis IAX direction of the 2nd lens system 7B. The drive unit 57 for adjusting the position u of the optic-axis IAX direction of the drive unit 62 for adjusting the position of the direction of two dimensions vertical to the drive unit 58 for adjusting and the optic axis of the 1st lens system 7A and the 2nd lens system 4B of the beam shaping system 5 is used. The drive units 57, 58, and 62 which comprise a micrometer of an electric type, etc. are also equipped with an encoder, respectively, Based on the drive information of the detecting signal of these encoders, and the main control system 22 of drawing 1, it is constituted so that the drive system 26 can control the state of the 2nd lens system 57, the 2nd lens system 7B, and the 1st lens system 7A via the drive units 57, 58, and 62.

[0036]Two or more luminous-energy-distribution sensing elements (diffraction optical element) which generate exposing light IL from which the irradiation area (intensity distribution) on the entrance plane of the 2nd fly eye lens 9 differs are provided in the swap device 56, The utilization efficiency of exposing light IL chooses the luminous-energy-distribution sensing element which becomes high, and it may be made to arrange in a lighting optical path most according to lighting conditions (namely, one [the intensity distribution of exposing light IL on the pupil surface of an illumination-light study system and two or more aperture diaphragms / 10a-10d / which are arranged in a lighting optical path in this example]. It is not necessary to form the 1st fly eye lens 6 in the swap device 56 at this time.

[0037]It returns to drawing 1 and adsorption maintenance of the reticle R is carried out on the reticle stage 31, and uniform movement can be carried out in the direction of Y on the reticle base 32, and the reticle stage 31 is laid so that it can move slightly to the direction of X, the direction of Y, and a hand of cut. The two-dimensional position of the reticle stage 31 (reticle R) and the angle of rotation are measured by real time with the laser interferometer in the drive controlling unit 34. Based on this measuring result and the control information from the main control system 22, the drive motors (a linear motor, a voice coil motor, etc.) in the drive controlling unit 34 perform the scan speed of the reticle stage 31, and control of a position. The evaluation mark board 33 which consists of glass substrates near the reticle R of the reticle stage 31 is being fixed.

[0038]In drawing 3 (a) is a top view showing the reticle stage 31 of drawing 1, and] this drawing 3 (a), The evaluation mark board 33 is fixed on the opening of the field which adjoins scanning direction SD (the direction of Y) to the reticle R of the reticle stage 31, In the field of the almost same size as the illuminated field 35 of the evaluation mark board 33, the same marks 36A and 36B for evaluation of 13 two dimensions and --36M are formed as an example by almost uniform distribution. Although the mark 36A for evaluation is a two-dimensional mark which combined the mark 37X of the X-axis which consists of a line and space pattern

arranged with the predetermined pitch in the direction of X, and the mark 37Y of the Y-axis which consists of a line and space pattern arranged with the predetermined pitch in the direction of Y, In addition, a box yne box mark etc. can be used. When measuring the amount of collapse of the tele centric nature of exposing light IL, i.e., the telecentricity of an illumination-light study system, like the after-mentioned in this example, the reticle stage 31 is driven in the direction of Y, The center (the center of the mark 36G for evaluation) of the evaluation mark board 33 is doubled with the center (optic axis AX) of the illuminated field 35, and the image of markA 36 and 36B for evaluation and --36M is projected on the wafer side via projection optical system PL. Image 36AP of the mark 36A for evaluation is shown in the enlarged drawing of drawing 3 (b).

[0039]Returning to drawing 1, adsorption maintenance is carried out on the wafer stage 39 via the wafer holder 38, and the wafer W carries out two-dimensional movement of the wafer stage 39 along an XY plane parallel to the image surface of projection optical system PL on the wafer base 40. Namely, it moves in the direction of Y with constant speed on the wafer base 40, and step moving of the wafer stage 39 is carried out in the direction of X, and the direction of Y. In the wafer stage 39, the position of the Z direction of the wafer W (focusing position), And Z leveling mechanism which controls the surrounding angle of inclination of the X-axis and a Y-axis is also incorporated, and the autofocus sensor (un-illustrating) of the multipoint for measuring a focusing position in two or more measure points of the surface of the wafer W is also formed. At the time of exposure, the surface of the wafer W focuses to the image surface of projection optical system PL by driving Z leveling mechanism by an autofocus method based on the measurement value of the autofocus sensor. At the time of measurement of a lighting characteristic, only arbitrary quantity can control the focusing position of the upper surface of the wafer stage 39 by driving Z leveling mechanism in the wafer stage 39 based on the measurement value of the autofocus sensor as an example.

[0040]The surrounding angle of rotation of the position of the direction of X of the wafer stage 39 and the direction of Y and the X-axis, a Y-axis, and the Z-axis is measured by real time with the laser interferometer in the drive controlling unit 41. Based on this measuring result and the control information from the main control system 22, the drive motors (linear motor etc.) in the drive controlling unit 41 perform the scan speed of the wafer stage 39, and control of a position.

[0041]The main control system 22 sends varieties of information, such as each movement zone of the reticle stage 31 and the wafer stage 39, movement speed, movement acceleration, and position offset, to the drive controlling units 34 and 41. And it synchronizes with the reticle R being scanned at the speed Vr in the direction (or the direction of -Y) of Y to the illuminated field 35 of exposing light IL via the reticle stage 31 at the time of scanning exposure, The wafer W is scanned in the direction (or the direction of -Y) of -Y to the exposure region 35P of the

pattern image of the reticle R via the wafer stage 39 by speed beta-Vr (beta is the projecting magnification from the reticle R to the wafer W). In order to prevent the exposure to a portion unnecessary at the time of the start of the scanning exposure in this case, and an end, the switching action of the movable blind 14B is controlled by the drive controlling unit 34.

[0042]The main control system 22 reads the various exposing conditions for carrying out scanning exposure of the photoresist of each shot region on the wafer W in the amount of appropriate exposure from an exposure data file, cooperates also with the exposure control unit 21, and performs the optimal exposure sequence. Namely, if instructions of the scanning exposure start to one shot region on the wafer W are emitted by the exposure control unit 21 from the main control system 22, the exposure control unit 21 will start luminescence of the exposure light source 1, and. The integral value of the illumination (sum of the pulse energy per unit time) of exposing light IL to the wafer W is computed via the integrator sensor 20. The integral value is reset by 0 at the time of a scanning exposure start. And the integral value of that illumination is computed one by one, and according to this result, the output (oscillating frequency and pulse energy) of the exposure light source 1 and the fading rate of the variable beam attenuator 3 are controlled by the exposure control unit 21 so that the amount of appropriate exposure is obtained on each point of the photoresist on the wafer W after scanning exposure. And luminescence of the exposure light source 1 is stopped at the time of the end of the scanning exposure to the shot region concerned.

[0043]Now, near the wafer holder 38 on the wafer stage 39 of this example, the illumination unevenness sensor 42 which consists of photoelectric detectors and has the pinhole-like light sensing portion 42a (refer to drawing 4 (a)) is installed, and the detecting signal S2 of the illumination unevenness sensor 42 is also supplied to the exposure control unit 21. The illumination unevenness sensor 42 may use the light sensing portion which consists of a line sensor or CCD prolonged along the scanning direction (the direction of Y) of the wafer W to the exposure region 35P instead of being the pinhole-like light sensing portion 42a combining it. In this case, each position of the non-scanning direction (the direction of X) which intersects perpendicularly with a scanning direction in the exposure region 35P. May integrate illumination about a scanning direction, may search for the illuminance distribution about a non-scanning direction based on this integrated value, and by this. The illuminance distribution of the non-scanning direction which considered the equalization effect of the illumination unevenness of the scanning direction by scanning exposure (illumination unevenness), i.e., the exposure value distribution about the non-scanning direction on the wafer after scanning exposure, (light exposure unevenness) can be acquired. Therefore, it may be made to optimize the lighting characteristic later mentioned using this measuring result (amendment of illumination unevenness). By carrying out two-dimensional movement of the wafer stage 39 at the time of illumination measurement, even if it uses the pinhole-like light sensing portion 42a,

it is possible to search for the same illuminance distribution.

[0044]Although not illustrated, The dose monitor which has a wrap light sensing portion is also installed in the whole exposure region 35P, and the coefficient for asking for the illumination on the wafer W indirectly from the detecting signal of the integrator sensor 20 is computed based on the detecting signal of this dose monitor, and the detecting signal of the integrator sensor 20. Near the wafer holder 38 on the wafer stage 39, the scanning plate 43 which consists of glass substrates is installed, and the square opening pattern 43a is mostly formed into the light-shielding film on the scanning plate 43. And the condenser 44 and the photoelectric detector 45 are arranged at the bottom side of the scanning plate 43 in the wafer stage 39, The space image measurement system 46 comprises the scanning plate 43, the condenser 44, and the photoelectric detector 45, and the detecting signal S3 of the photoelectric detector 45 is supplied to the operation part in the exposure control unit 21.

[0045]The space image measurement system 46 may establish only the part (for example, in this example, the scanning plate 43 and at least a part of light transmission system containing the condenser 44 etc. are included) in the wafer stage 39, and may arrange the remaining components (photoelectric detector 45 etc.) to the exterior of the wafer stage 39. At the time of measurement of the lighting characteristic which only one open ROPATAN 43a is formed in the scanning plate 43, and is mentioned later, the space image measurement system 46. Although stepping of the wafer stage 39 is carried out in two dimensions and relative displacement of the opening pattern 43a is carried out to a scanning direction and a non-scanning direction (the direction of Y, and the direction of X) to each of the image of the mark for evaluation of plurality (this example 13 pieces) arranged in the illuminated field 35, respectively, At for example, the time of the relative displacement of the image of the mark for evaluation and an opening pattern form the two or more marks for evaluation and opening pattern 43a of the same number in the scanning plate 43, and concerning a scanning direction. Package detection of the image of two or more of the marks for evaluation may be carried out, respectively at the time of the relative displacement of the image of the mark for evaluation and opening pattern about a non-scanning direction.

[0046]Form in the scanning plate 43 the mark for evaluation of plurality (this example five pieces) and the opening pattern 43a of the same number which separate to a non-scanning direction among two or more of the marks for evaluation along a non-scanning direction, and the wafer stage 39 is moved to a scanning direction, May detect continuously the image of each mark for evaluation arranged in a scanning direction for every opening pattern, and, Contrary to this, open ROPATAN 43a of the mark for evaluation and the same number may be formed in the scanning plate 43 about a scanning direction, the wafer stage 39 may be moved to a non-scanning direction, and the image of the mark for evaluation may be continuously detected for every opening pattern. At this time, it is preferred to drive the movable blind 14B

according to movement of the wafer stage 39 so that exposing light IL may be irradiated by a part of illuminated field 35 during detection of two or more of those marks for evaluation. When carrying out relative displacement of the image and opening pattern of the mark for evaluation about a non-scanning direction by the former method, When it is necessary to make a scanning direction carry out stepping of the wafer stage 39 and relative displacement of the image and opening pattern of the mark for evaluation is carried out about a scanning direction by the latter method, In order to make a non-scanning direction carry out stepping of the wafer stage 39, it is also good to move the wafer stage 39 to a scanning direction and a non-scanning direction 1 time respectively combining both.

[0047]For example, after moving the opening pattern 43a of the scanning plate 43 before image 36AP in measuring the position of the direction of Y of image 36AP of the mark 36A for evaluation as shown in drawing 3 (a) and (b), the wafer stage 39 is driven and image 36AP is scanned with the opening pattern 43a. In this case, it is supplied to the exposure control unit 21 via the main control system 22 by the position information on the wafer stage 39, and in the operation part in the exposure control unit 21. From the signal acquired by differentiating the detecting signal of the photoelectric detector 45 about the position of the direction of X of the wafer stage 39, the position of the direction of Y of image 36AP is computed. By scanning image 36AP in the direction of X with the opening pattern 43a similarly, the position of the direction of X of image 36AP is also computed, and the position information on the direction of X of image 36AP and the direction of Y is supplied to the main control system 22.

[0048]It returns to drawing 1 and the illumination unevenness sensor 42 and the space image measurement system 46 by the side of the evaluation mark board 33 on the reticle stage 31 and the wafer stage 39 support the characteristic measurement system which measures the predetermined lighting characteristic (optical property) of this invention. Next, it explains per example of the adjusting operation for optimizing the predetermined lighting characteristic of an illumination-light study system of this example. In this example, as the 1st group of the predetermined lighting characteristic, dispersion in the illuminance distribution of exposing light IL in the illuminated field 35 and by extension, the exposure region 35P. The amount of collapse of the tele centric nature of (it being hereafter called "illumination unevenness") and exposing light IL to the reticle R (it is hereafter called lighting TERESEN) is chosen. This is for these two lighting characteristics to have biggest influence to the photoresist on the projection image by projection optical system PL, and the wafer W.

[0049]And the illumination unevenness is divided into the secondary ingredient (this is called "a concavo-convex ingredient") about the primary ingredient (this is called slant components) about the position of the non-scanning direction (the direction of X) of the exposure region 35P, and its position. That is, if illumination is made into function $PF(X)$ of the position X, illumination $PF(X)$ can be approximated as follows, the coefficient a will serve as slant

components and the coefficient b will serve as a concavo-convex ingredient. In this case, since the illumination unevenness ingredient of a scanning direction (the direction of Y) is equalized by scanning exposure, it has not been made in particular into the evaluation object by this example. The concavo-convex ingredient is also a symmetrical ingredient (axial symmetry ingredient) about an optic axis.

[0050]

$PF(X) = a \cdot X - b \cdot X^2 + \text{offset} \quad (1)$

The lighting TERESEN is divided into the slant components (shift ingredient) c and d corresponding to the angle of inclination to the average direction of X and the direction of Y of exposing light of in the illuminated field 35 (exposure region 35P), and the magnification components e corresponding to the average angle of inclination which receives radially to the optic axis of exposing light. In this case, in this example, the focusing position of the wafer stage 39 is set as the position which only **delta made defocus to a focusing position, The position (the amount of distortion) of the image of many marks for evaluation is measured by the space image measurement system 46 in each focusing position, The slant components c and d can be calculated from the average shift amount of the image of the mark for evaluation to the variation of a focusing position, and the magnification components e can be calculated from the average shift amount of the image of those marks for evaluation which receives radially.

[0051]As explained with reference to drawing 2, the state of the 2nd fly eye lens 9, the 1st lens system 12, and the 2nd lens system 13 is controllable by this example via the five drive units 23, 24, 25X, 25Y, and 25T, respectively, but. Each of above-mentioned lighting characteristics can be controlled by these control almost independently as follows.

(a2) Justification of the optical axis direction of the 2nd fly eye lens 9 by the 1st drive unit 23 : Magnification-components [of lighting TERESEN] e [mrad], (b2) Justification of the optical axis direction of the 1st lens system 12 by the 2nd drive unit 24 : Concavo-convex ingredient [of illumination unevenness] b [mrad], (c2) Justification of the x direction of the 2nd lens system 13 by the 3rd drive unit 25X : Slant-components [of the direction of X of lighting TERESEN] c [mrad], (c3) justification of the y direction of the 2nd lens system 13 by the 4th drive unit 25Y : -- slant-components [of slant-components / of the direction of Y of lighting TERESEN] d [mrad], and the non-scanning direction of the tilt angle adjustment:illumination unevenness of the 2nd lens system 13 by the 5th (d2) drive unit 25T a [mrad].

[0052]Thus, when the state of an optical member corresponding with one arbitrary drive unit in two or more drive units 23-25T is controlled by this example, The combination of the optical member which can control a state so that only only one kind of lighting characteristic (optical property) changes substantially and other lighting characteristics do not change is optimized. By this, it is easy control and automatic adjustment of a lighting characteristic can be

performed with high precision. All fundamental lighting characteristics are automatically controllable by considering it as the five number of a drive unit. However, in making the lighting characteristic of a controlled object only for example, into lighting TERESEN, the number of a drive unit and arrangement change according to the lighting characteristic of a controlled object, such as considering it as the three number of a drive unit.

[0053]Also as for a possibility of affecting [actually] it to other lighting characteristics slightly among five drive units, for a certain reason, it is desirable to also take into consideration influence on other lighting characteristics. For this reason, as first shown in the flow chart of drawing 8, when the unit quantity drive of the five drive units 23, 24, 25X, 25Y, and 25T is carried out, it asks for the drive rate which shows which can change a lighting characteristic.

[0054]That is, in Step 101 of drawing 8, the aperture-diaphragm board 10 of drawing 1 is controlled, and lighting conditions are usually set up for any of lighting, deformation illumination (4 very zona-orbicularis lighting or lighting), or small sigma value lighting being. In the following step 102, the five drive units 23 - the i-th drive unit ($i = 1-5$) in 25T are chosen. Here, the 2nd drive unit 24 corresponding to the 1st lens system 12 should be chosen. In the following step 103, where it set up the drive quantity d_2 of the drive unit 24 in the center ($d_2 = 0$) of a driving feasible range and the 1st lens system 12 is set as the optical origin which is a design position, measurement of illumination unevenness and lighting TERESEN is performed.

[0055]In order to measure the illumination unevenness, the glass substrate in which a pattern is not formed instead of the reticle R on the reticle stage 31 in drawing 1 is installed, The illuminated field 35 is irradiated with exposing light IL, the exposure region 35P is scanned to a non-scanning direction (the direction of X) by the light sensing portion of the illumination unevenness sensor 42, and the detecting signal S2 of the illumination unevenness sensor 42 is incorporated into the exposure control unit 21. The field in which the mark for evaluation in the field in which the pattern of the reticles R is not formed instead of or the evaluation mark board 33 is not formed may be used. [the glass substrate]

[0056]Drawing 4 (a) shows the state of scanning the exposure region 35P in the direction of X by the light sensing portion 42a of the illumination unevenness sensor 42, and shows the detecting signal S2 which the curve 51A of drawing 4 (b) was made to correspond to the position of the direction of X of the illumination unevenness sensor 42 (wafer stage 39) then, and was plotted. The operation part in the exposure control unit 21 of this example computes the value a_1 of the slant components a of illumination unevenness, and the value b_1 of the concavo-convex ingredient b by approximating the curve 51A with a least square method to the right-hand side of (1) type. The starting point of the direction of X in this case is used as the optic axis AX of projection optical system PL. As a dotted line shows the curve 51A, when it is divided into the primary straight line 52A and the secondary curve 53A, inclination of the straight line 52A is set to a_1 , and the coefficient of X^2 of the secondary curve 53A is set to b_1 .

[0057]Next, in order to measure lighting TERESEN, in drawing 1, the reticle stage 31 is driven, the center of the evaluation mark board 33 is moved to the center of the illuminated field 35, the wafer stage 39 is driven, and the scanning plate 43 of the space image measurement system 46 is moved near the exposure region 35P. And drive Z leveling mechanism in the wafer stage 39, and only +delta sets up the focusing position of the scanning plate 43 highly from the image surface (best focus positions) over projection optical system PL (delta is beforehand set up within limits from which predetermined resolution is obtained), The exposure of exposing light IL is started, and as shown in drawing 5 (a), image 36AP of the marks 36A-36M for evaluation of the evaluation mark board 33 - 36MP are projected on the wafer stage 39. As explained with reference to drawing 3 (b) in this state, those image 36AP - 36MP are scanned in the direction of X, and the direction of Y with the opening pattern 43a of the scanning plate 43, By processing the detecting signal S3 acquired by the operation part in the exposure control unit 21, the position of the direction of X of those image 36AP - 36MP and the direction of Y is computed, and a computed result is supplied to the main control system 22. The starting point in this case is the center of image 36GP of the central mark 36G for evaluation, for example.

[0058]It is desirable to irradiate with exposing light IL only the mark for evaluation which drives the movable blind 14B according to movement of the wafer stage 39 and from which a part of illuminated field 35 should detect the image, for example by the space image measurement system 46 during the above-mentioned detecting operation. Thus, let the images of the marks 36A-36M for evaluation which only delta made defocus the scanning plate 43 and were measured be the images 54A-54M on the lattice of the dotted line of drawing 5 (a). There is a thing of explanation which has been actually distorted by distortion for convenience as for a certain grade although the lattice of the dotted line is drawn on the rectangle.

[0059]Next, it is from best focus positions about the focusing position of the scanning plate 43. - Only delta is set up low, searches for the position of the direction of X of the marks 36A and 36B for evaluation, image 36AP of -36M - 36MP, and the direction of Y using the space image measurement system 46 similarly, and is supplied to the main control system 22. Image 36AP in this case - 36MP, and the images 54A-54M measured previously are displayed on drawing 5 (a). As opposed to the images 54A-54M when only +delta makes a focusing position defocus in the main control system 22 as shown in drawing 5 (a), Focusing position - The two-dimensional amount of position gaps to the direction of X of image 36AP at the time of making only delta defocus - 36MP and the direction of Y is calculated as vector $\langle VA \rangle - \langle VM \rangle$. It is computed as the average value $\langle V2 \rangle$ ($e1$) of the ingredient to a radial direction (the direction of R) shows drawing 5 (b) and (c) to the simple average value $\langle V1 \rangle$ ($(c1, d1)$) of these vectors, and the starting point. Average value $(c1, d1)$ is slant components of lighting TERESEN, and the average value $e1$ is magnification components of lighting TERESEN.

[0060]Next, in Step 104, where the drive quantity d2 of the drive unit 24 is set as the end ($d_2=d_{2\ max}$) by the side of + of a driving feasible range, measurement of illumination unevenness and lighting TERESEN is performed. As shown in drawing 4 (c), the curve 51B of the detecting signal S2 of the illumination unevenness sensor 42 is obtained by this, and the slant components a2 and the concavo-convex ingredient b2 of illumination unevenness are obtained by dividing this curve 51B into the primary straight line 52B and the secondary curve 53B. As shown in drawing 5 (e) and (f), the slant components (c2, d2) of lighting TERESEN and the magnification components e2 of lighting TERESEN are obtained from vector <VA> of a position gap of image 36AP of the marks 36A-36M for evaluation of drawing 5 (d) - 36MP - <VM>.

[0061]Next, in Step 105, where the drive quantity d2 of the drive unit 24 is set as the end ($d_2 = d_{2\ max}$) by the side of - of a driving feasible range, measurement of illumination unevenness and lighting TERESEN is performed. The slant components a3 of illumination unevenness, the concavo-convex ingredient b3 and the slant components (c3, d3) of lighting TERESEN, and the magnification components e3 are similarly obtained by this. It is desirable to set the drive quantity of the drive unit 24 as four or more places, and to measure illumination unevenness and lighting TERESEN to compute a drive rate with high precision.

[0062]In subsequent Step 106, the drive rate of the drive unit 24 (the 1st lens system 12) is computed using the above-mentioned measurement value. Since the slant components a of illumination unevenness when the drive quantity d2 is set as 0, $d_{2\ max}$, and $-d_{2\ max}$ as an example are a1, a2, and a3, respectively, they are as follows. of the drive rate ka2 to the slant components a [%/mm]

$$ka2 = (a2-a1)/d_{2\ max} - (a3-a1)/(2 \text{ and } d_{2\ max}) / 2 \quad (2)$$

[0063]Similarly The concavo-convex ingredient b of illumination unevenness, the slant components c and d of lighting TERESEN. And drive rate kb2 mm to the magnification components e of lighting TERESEN, kc2 mrad/mm, kd2 mrad/mm, and ke2 mrad/mm are computed, and the storage parts store within the main control system 22 memorizes. In this case, although a dominant value is only drive rate kb2 to the concavo-convex ingredient b of illumination unevenness, it may be memorized as it is about what is over the predetermined level also with other values, and may be memorized as 0 about the value in a predetermined level.

[0064]When driving the 1st lens system 12 concretely, drive rate ke2 to the magnification components e of lighting TERESEN which has the characteristic of central symmetry (axial symmetry) as well as the concavo-convex ingredient b may exceed a predetermined level. Thus, the drive rate kai, kbi, kci, kdi, and kei (i = 1-5) are computed by performing operation of Steps 102-106 about all the drive units 23-25T, and it memorizes as a parameter for every

lighting conditions in the main control system 22. Then, it shifts to Step 108 from Step 107, and judges whether the drive rate was computed about all the required lighting conditions, and when not having ended, a drive rate is computed by returning to Step 101 and switching lighting conditions. Although a drive rate shall be computed about all the lighting conditions here, This example is not limited to this, and computes a drive rate, for example about a part of all the lighting conditions, and it may be made to determine a drive rate by interpolation calculation etc. based on the drive rate of other lighting conditions about the remaining lighting conditions.

[0065]under the present circumstances -- alike -- the case of the 2nd drive unit 24 (the 1st lens system 12) -- a center -- originally drive rate ka_2 about an unsymmetrical ingredient, kc_2 , and kd_2 are the quantity of the grade which can be disregarded. When these drive rates are larger than a certain value, the 1st lens system 12 may be carrying out eccentricity, or it may lean, such faults can be detected in this stage, and it can adjust based on this.

[0066]Next, with reference to the flow chart of drawing 9, it explains per which adjusts an illumination-light study system automatically using the drive rate for which it asked as mentioned above example of a sequence. First, in Step 111 of drawing 9, lighting conditions are chosen via the aperture-diaphragm board 10 of drawing 1, the drive quantity of all the drive units 23, 24, 25X-25T is set as a center valve position, and a corresponding optical member is set as an optical origin. In the following step 112, illumination unevenness and lighting TERESEN are measured like Step 103 of drawing 8. And in Step 113, in the procedure shown in drawing 4 and drawing 5, the slant components (primary ingredient) a of illumination unevenness and the concavo-convex ingredient (secondary ingredient) b are computed, and the slant components (shift ingredient) c and d and the magnification components e of lighting TERESEN are computed. When the illumination unevenness a and b and lighting TERESEN c , d , and e judge whether it is inside of tolerance level in the following step 114, respectively and any they are has separated from tolerance level, it shifts to Step 115, The drive quantity di (i 1-5) of the five drive units 23-25T for being on calculation, respectively and setting the illumination unevenness a and b and lighting TERESEN c , d , and e to 0 is computed using the drive rate kai memorized in the main control system 22, kbi , kci , kdi , and kei (i 1-5). In this case, what is necessary is just to solve the following simultaneous equations.

[0067]- $a=ka_1$, $d_1=ka_2$, $d_2=ka_3$, $d_3=ka_4$, $d_4=ka_5$, $d_5-b=kb_1$, $d_1=kb_2$, $d_2=kb_3$, $d_3=kb_4$, $d_4=kb_5$, $d_5-c=kc_1$, $d_1=kc_2$, $d_2=kc_3$, $d_3=kc_4$, $d_4=kc_5$, $d_5-d=kd_1$, $d_1+kd_2=d_2+kd_3$, $d_3=kd_4$, $d_4=kd_5$, $d_5-e=ke_1$, $d_1=ke_2$, $d_2=ke_3$, $d_3=ke_4$, $d_4=ke_5$, and d_5 -- however, actually, Since it is one piece or about two pieces in each line, what is not 0 in these drive rates can solve these simultaneous equations very easily. The computed drive quantity di (i 1-5) is also made to correspond to each of two or more lighting conditions, and is saved as a parameter at the storage parts store within the main control system 22.

[0068]Both the drive unit 24 and the drive unit 23 affect the concavo-convex ingredient b of illumination unevenness, and the magnification components e of lighting TERESEN concretely, Both the drive unit 25T and the drive unit 25X are considered that there is a relation that affect the slant components a of illumination unevenness and the slant components c of lighting TERESEN, and only the drive unit 25Y affects the slant components d of lighting TERESEN.

[0069]Next, it shifts to Step 116 and only the drive quantity di (i = 1-5) computed, respectively drives the five drive units 23-25T. Then, in [shift to Step 112,113, re-measure the illumination unevenness a and b and lighting TERESENc d, and e, and Step 114, When those values all are not settled in tolerance level, it shifts to Step 115 again and calculation is performed, and an automatic regulation is ended when those values are all settled in tolerance level. And when the same lighting conditions as the next are set up, based on the drive quantity di memorized, adjustment of an illumination-light study system is extremely completed only by driving the drive units 23-25T for a short time.

[0070]Thus, in this example, since a lighting characteristic is automatically measurable, Assis Torres can perform all of the measurement sequence of the drive rate of drawing 8, and the automatic regulation sequence of an illumination-light study system of drawing 9. Next, it explains per example of the adjustment method in the case of installing the aperture diaphragm 10b (or 4 very aperture diaphragm 10c of lighting) of zona-orbicularis lighting in the projection surface of the 2nd fly eye lens 9 by the illumination-light study system of this example, as shown in drawing 6 (a), and performing deformation illumination.

[0071]In this case, the luminous-energy-distribution sensing element 55 which consists of diffraction optical elements (DOE) instead of the 1st fly eye lens 6 of drawing 1 is installed. Cone prism (an axicon, for zona-orbicularis lighting) or prism, such as prism (4 very for lighting) of square coning (pyramid type), may be used instead of a diffraction optical element. And in order that the aperture diaphragm used may respond for any of the aperture diaphragm 10b or 10c being and may adjust the irradiation area of exposing light IL to the 2nd fly eye lens 9, The 1st lens system 7A can be driven in the direction vertical to an optic axis with the drive unit 62, and it enables it to drive the 2nd lens system 7B to an optical axis direction with the drive unit 58. An optical system which rotates an optical system to which a zoom optical system and aberration are continuously changed instead of or a cylindrical lens, and makes a beam cross section distorted may be used. [the condensing optical system (beam forming optical system) which consists of the lens systems 7A and 7B

[0072]In the case of the optical system of drawing 6 (a), it is confirmed by this invention person that illumination unevenness changes with the illuminated fields at the time of illuminating the 2nd fly eye lens 9 locally rapidly. The change factor of the illumination unevenness is concretely divided into the following factors.

1) When partial illumination area is small, since there is much light volume which passes an

aperture diaphragm, image surface illumination rises, but among the effective elements of the 2nd fly eye lens 9, some are illuminated halfway and this has an adverse effect on illumination unevenness.

[0073]2) When partial illumination area is large, illumination unevenness does not deteriorate, but the light volume naturally interrupted by the aperture diaphragms 10b and 10c increases, and image surface illumination falls.

3) the case where partial illumination area is carrying out eccentricity -- the lighting unevenness on the image surface -- right and left -- there is a tendency (slant components) for either to become low. This originates in having a size with each limited element of the 2nd fly eye lens 9. Therefore, in this example, when performing deformation illumination using the luminous-energy-distribution sensing element 55, as shown in drawing 10, the special adjustment sequence is prepared.

[0074]Then, in Step 121 of drawing 10, it is in the state of drawing 1, namely, it is usually set as lighting, and drive rate measurement of drawing 8 and the automatic regulation sequence of drawing 9 are performed. In the following step 122, as shown in drawing 6 (a), the 1st fly eye lens 6 is changed into the luminous-energy-distribution sensing element 55, and the aperture diaphragm of the projection surface of the 2nd fly eye lens 9 is set as the aperture diaphragm 10b for deformation illuminations, or 10c. In the following step 123, illumination unevenness is measured using the illumination unevenness sensor 42 of drawing 1, and as shown in drawing 4, the slant components a and the concavo-convex ingredient b are computed. In this case, when the illumination unevenness of an extreme inclination occurs on both sides of the non-scanning direction of illuminance distribution and the slant components a exceed tolerance level, partial illumination area may be carrying out eccentricity as mentioned above. In this case, the 1st lens system 7A is shifted in the direction corresponding to the direction of X, and the direction of Y in a field vertical to an optic axis so that those slant components a may be settled in tolerance level.

[0075]And let the concavo-convex ingredient b of illumination unevenness be an evaluation object in this state. Namely, shift to Step 124, judge the concavo-convex ingredient b in tolerance level , and when it is outside tolerance level, it shifts to Step 125, Since only a predetermined step amount shifts the 2nd lens system 7B to an optical axis direction, it returns to Step 123, and the concavo-convex ingredient b of illumination unevenness is measured again, and ***** [it / in tolerance level] is judged. This correction operation is performed until the concavo-convex ingredient b is settled in tolerance level at Step 124.

[0076]After the concavo-convex ingredient b is settled in tolerance level at Step 124, it shifts to Step 126, The lens system 4B of the beam shaping system 5 of drawing 6 (a) is changed to specified quantity every order in an optical axis direction (scanning), Scan to a non-scanning direction in the exposure region 35P which does not have a pattern image in the illumination

unevenness sensor 42 of drawing 1 in each position (position u) of the lens system 4B, and the data row of the detecting signal S2 is incorporated into the exposure control unit 21, and the detecting signal S1 of the integrator sensor 20 is also incorporated into the exposure control unit 21.

[0077]In the following step 127, in each position u of the lens system 4B, difference deltaIP of the maximum of the detecting signal S2 (illumination) and the minimum is calculated as illumination unevenness, and size (average value) IP of the illumination in the image surface is indirectly calculated from the detecting signal S1 of the integrator sensor 20. And the operation part in the exposure control unit 21 matches the reciprocal (1/deltaIP) of illumination unevenness deltaIP, and image surface illumination IP to each position u of the lens system 4B. The figure which plotted the reciprocal (1/deltaIP) of image surface illumination IP and illumination unevenness to the position u is drawing 7 so that intelligibly.

[0078]In drawing 7, a horizontal axis is the position u of the lens system 4B, and a vertical axis is a reciprocal (1/deltaIP) of image surface illumination IP and illumination unevenness deltaIP. And the curve 59 expresses image surface illumination IP, and the curve 60 expresses the reciprocal (1/deltaIP) of illumination unevenness. In this case, if image surface illumination IP becomes large, since the reciprocal (1/deltaIP) of illumination unevenness will become small and illumination unevenness will become large, it turns out that image surface illumination and illumination unevenness are the relations of a trade-off. So, in this example, the main control system 22 is supplied in quest of the range 61 ($u_1 < u < u_2$) of the position u from which image surface illumination becomes more than acceptable value tangent line1 (position u_2), and the reciprocal of illumination unevenness becomes more than acceptable value tangent line2 (position u_1) as a range of the lens system 4B which can be set up.

[0079]In the following step 128, the main control system 22 of drawing 1 sets up the position u of the lens system 4B of drawing 6 (a) via the drive system 26 in which can be set up the range 61. High image surface illumination is obtained by this, the throughput of an exposure process can be improved by it, and illumination unevenness becomes small and high image formation accuracy is obtained. If the optical element for deformation illuminations is shifted to an optical axis direction when detailed random illumination unevenness is measured on the image surface, random illumination unevenness can be made to cancel. As mentioned above, although the characteristic of various kinds of illumination-light study systems changes by making the arbitrary optical members of an illumination-light study system drive, illumination unevenness and the last spurt accuracy of lighting TERESEN can be raised more by choosing these in a design stage and building the optimal drive unit into an automatic regulation sequence.

[0080]In the above-mentioned embodiment, although both illumination unevenness and telecentricity shall be measured (detection), it is good to even measure either. Although the

slant components were divided in the direction of X, and the direction of Y and were measured in telecentricity, only either has a good thing. Although the exposure device of a scanning exposure manner shall detect the illumination unevenness of a non-scanning direction in the above-mentioned embodiment, it is preferred for the direction of X and the direction of Y to detect illumination unevenness in the exposure device of a standstill exposure method, respectively, and to perform the amendment.

[0081]Although the adjustment shall be performed in each of above-mentioned embodiments at the time of measurement of a lighting characteristic (lighting TERESEN and illumination unevenness at least on the other hand), a lighting characteristic may be adjusted in addition to the time of the measurement. For example, change of a lighting characteristic may be calculated (simulation etc.) and a lighting characteristic may be adjusted one by one based on this calculation result. Measure a lighting characteristic periodically, and the adjustment is performed, and it may be made to adjust a lighting characteristic by the above-mentioned calculation between the periodical measurement. It is also good to adjust only a concavo-convex ingredient until it adjusts both the slant components of illumination unevenness, and a central symmetry ingredient (concavo-convex ingredient) about illumination unevenness at the time of change of the intensity distribution (especially the shape) of exposing light IL on the pupil surface of lighting conditions, i.e., an illumination-light study system, and then changes lighting conditions.

[0082]Although the luminous-energy-distribution sensing element 55 shall be arranged in the optical path of exposing light in exchange for the 1st fly eye lens 6 in drawing 6 (a) at the time of deformation illumination, For example, it may be made to arrange the luminous-energy-distribution sensing element 55 between the exposure light source 1 and an optical integrator (this example the 1st fly eye lens 6). It may be made to exchange for another element which generates luminous energy distribution which is different in that luminous-energy-distribution sensing element 55 according to change of lighting conditions at this time. It may be made to exchange the luminous-energy-distribution sensing element 55 with zona-orbicularis lighting and 4 pole lighting also in the example of composition of drawing 6 (a).

[0083]Although the lighting condition change system of drawing 1 shall contain both the aperture-diaphragm board 10 and the swap device 56 which performs exchange of an optical integrator (the 1st fly eye lens 6) and a luminous-energy-distribution sensing element (diffraction optical element 55), The lighting condition change system is also good to perform only exchange of two or more luminous-energy-distribution sensing elements which accepted it, or may contain only the swap device 56, and mentioned the swap device 56 above aperture-diaphragm board 10. Instead of the aperture-diaphragm board 10 and the swap device 56, for example, combining either at least the aperture-diaphragm board 10 or the swap device 56 A zoom optical system, At least one side with the prism (cone prism (axicon) or pyramid prism)

of a couple in which relative displacement is possible may be arranged to the optical axis direction of an illumination-light study system between the exposure light source 1 and an optical integrator (the 2nd fly eye lens 9).

[0084]in the above-mentioned embodiment, although the fly eye lenses 6 and 9 are used as an optical integrator, also when using an internal reflection type integrator (rod integrator) as an optical integrator, it is in difference that this invention is applicable. Although illumination-light study system ILS of what is called a double fly eye method which uses two steps of fly eye lenses 6 and 9 is used in the above-mentioned embodiment, This invention can be applied also when adjusting the illumination-light study system only using one step of optical integrators (a fly eye lens, a rod integrator, etc.). Not only deformation illumination but the diffraction optical element (DOE) of the above-mentioned [lighting or the lighting of a small sigma value usually may be used as an optical integrator. It is desirable to, prepare two or more diffraction optical elements in this case, of course, and to perform that exchange according to lighting conditions.

[0085]An entrance plane is arranged as an optical integrator (9) in the pupil surface of an illumination-light study system, for example, And a projection surface using the internal reflection type integrator arranged at the pattern surface side of the reticle R, and conjugate and between the exposure light source 1 and an optical integrator (9), When arranging two or more luminous-energy-distribution sensing elements (diffraction optical element) mentioned above, a zoom optical system, and the optical unit containing at least one of the prism of a couple, the incidence angle degree range of exposing light IL which enters into the internal reflection type integrator will be changed at the time of change of lighting conditions. When using a fly eye lens as an optical integrator (9), the surface light source which is from two or more light source images on the projection surface side, i.e., a secondary light source, is formed, and when using an internal reflection type integrator, the secondary light source which is from two or more virtual images on the entrance plane side is formed. Therefore, change of the lighting conditions in each above-mentioned embodiment is equivalent to changing either [which is formed on changing the intensity distribution of exposing light IL on the pupil surface of an illumination-light study system, and the pupil surface of an illumination-light study system / at least] the size of a secondary light source, or shape.

[0086]Although the above-mentioned embodiment applies this invention to the projection aligner of a scanning exposure manner, this invention is applicable also to exposure devices, such as a projection aligner (stepper) of a step-and-repeat method (one-shot exposure method), and a proximity method which does not use a projection system. Exposing light (exposure beam) is not restricted to the above-mentioned ultraviolet radiation, and may use the EUV light of the soft-X-ray field (wavelength of 5-50 nm) generated, for example from a laser-plasmas light source or a SOR (Synchrotron Orbital Radiation) ring. An illumination-light

study system and a projection optical system are constituted only from two or more catoptric light study elements by EUV aligner, respectively.

[0087]And a semiconductor device can be manufactured from the wafer W of drawing 1. The step to which the semiconductor device performs the function and performance design of a device, The step which manufactures the reticle based on this step, the step which makes a wafer from a silicon material, It is manufactured through the step which exposes the pattern of reticle to a wafer with the projection aligner of an embodiment mentioned above, a device assembly step (a dicing process, a bonding process, and a package process are included), an inspection step, etc.

[0088]Without being limited to the exposure device for semiconductor device manufacture as a use of an exposure device, For example, it is widely applicable also to the exposure device for manufacturing various devices, such as an exposure device for display devices, such as a liquid crystal display element formed in a square-shaped glass plate, or a plasma display, image sensors (CCD etc.), a micromachine, a thin film magnetic head or a DNA chip. This invention is applicable also to the exposure process (exposure device) at the time of manufacturing the masks (a photo mask, reticle, etc.) in which the mask pattern of various devices was formed using a photolitho GUFI process.

[0089]Of course, various composition can be taken in the range which this invention is not limited to an above-mentioned embodiment, and does not deviate from the gist of this invention.

[0090]

[Effect of the Invention According to this invention, the illumination system (illumination-light study system) of an exposure device can be adjusted in a short time correctly. When it has a characteristic measurement system which measures the lighting characteristic of an illumination system, the illumination system which has two or more lighting conditions can be adjusted automatically. When dividing and measuring the slant components and magnification components of the amount of collapse (telecentricity of an illumination system) of an exposure beam as a lighting characteristic, it can adjust in a short time correctly by adjusting both independently. [of tele centric nature]

[Translation done.]

*** NOTICES**

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings

Drawing 1 It is the front view which cut and lacked the part which shows the projection aligner of an example of an embodiment of the invention.

Drawing 2 It is a perspective view showing the optical system and the illuminated field 35 from the 2nd fly eye lens 9 of drawing 1 to the 2nd lens system 13.

Drawing 3 (a) is a top view showing the reticle stage 31 and the evaluation mark board 33, and an enlarged plan view which presents explanation of the detecting method of image 36AP of the mark for evaluation with (b).

Drawing 4 It is an explanatory view of the instrumentation method of the slant components of illumination unevenness, and a concavo-convex ingredient.

Drawing 5 It is an explanatory view of the instrumentation method of the slant components of lighting TERESEN, and magnification components.

Drawing 6 The figure which cut and lacked the part which shows an important section in case (a) performs deformation illumination in illumination-light study system ILS of drawing 1, and (b) are the front views showing the aperture-diaphragm board 10 of drawing 6 (a).

Drawing 7 It is a figure showing an example of the relation between the size of the illumination in the case of performing deformation illumination, and illumination unevenness.

Drawing 8 It is a flow chart which shows an example of the measurement sequence of the drive rate of all the drive units in an illumination-light study system.

Drawing 9 It is a flow chart which shows an example of the automatic regulation sequence of an illumination-light study system.

Drawing 10 It is a flow chart which shows an example of the adjustment sequence for deformation illuminations.

[Description of Notations

1 [-- The 2nd fly eye lens,] -- An exposure light source, 5 -- A beam shaping system, 6 -- The

1st fly eye lens, 9 10 [-- Fixed blind, -- An aperture-diaphragm board, 12 -- The 1st lens system, 13 -- The 2nd lens system, 14A R [-- Integrator sensor, -- Reticle, PL -- A projection optical system, W -- A wafer, 20 21 [-- A drive system, 31 -- A reticle stage, 33 / -- An evaluation mark board, 36A-36M / -- The mark for evaluation, 42 -- An illumination unevenness sensor, 46 -- A space image measurement system, 55 / -- Luminous-energy-distribution sensing element] -- An exposure control unit, 22 -- A main control system, 23, 24, 25X, 25Y, 25T -- A drive unit, 26

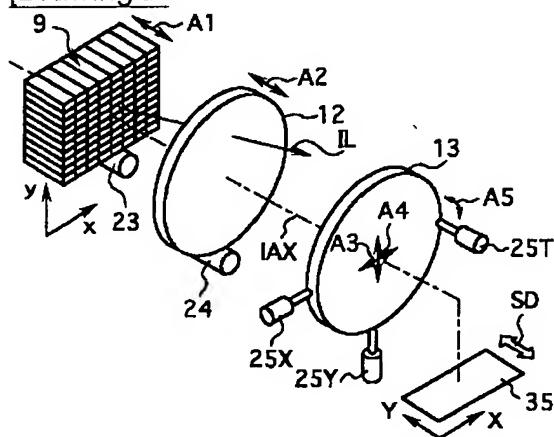
[Translation done.]

* NOTICES

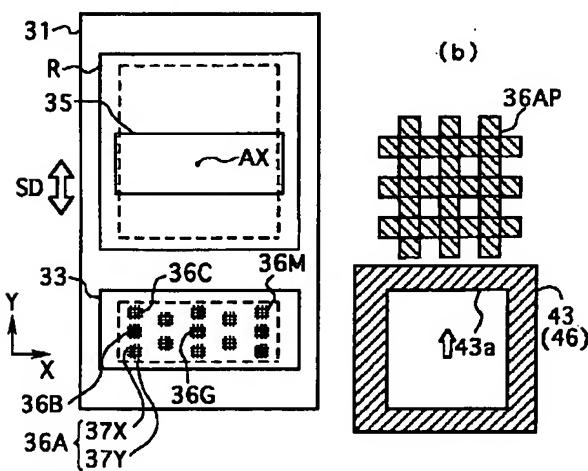
JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

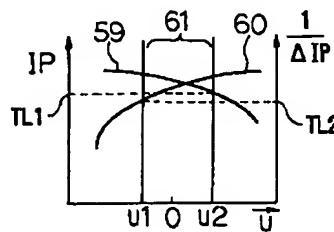
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

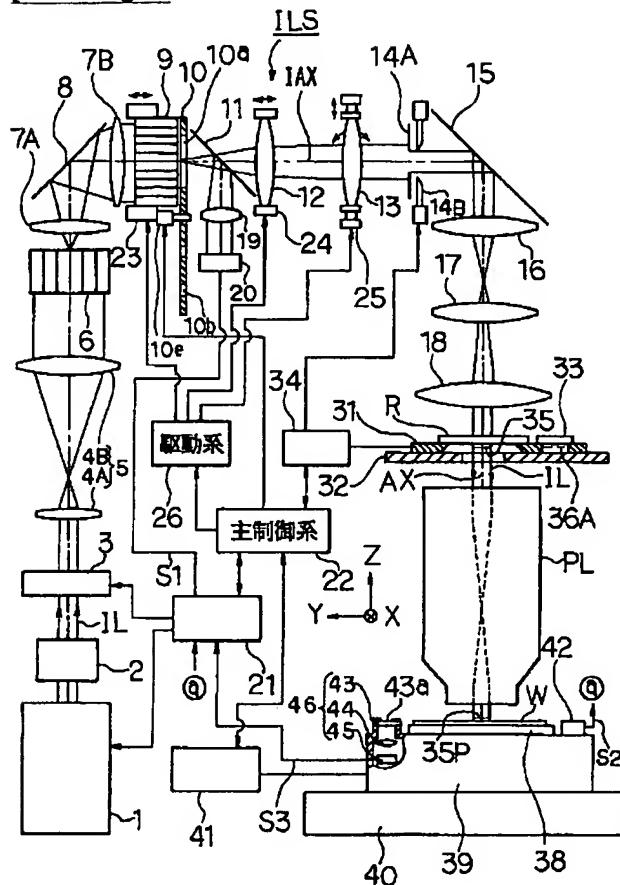
[Drawing 2][Drawing 3]

(a)

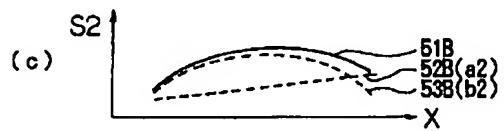
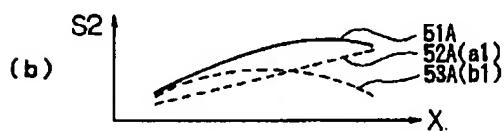
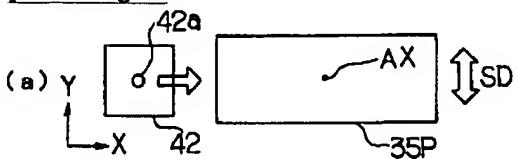
[Drawing 7]

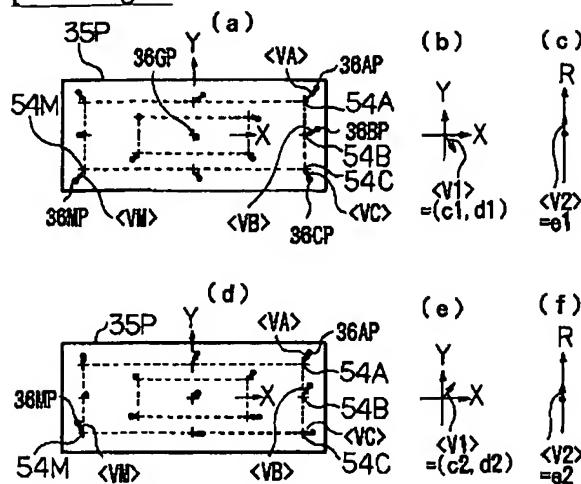
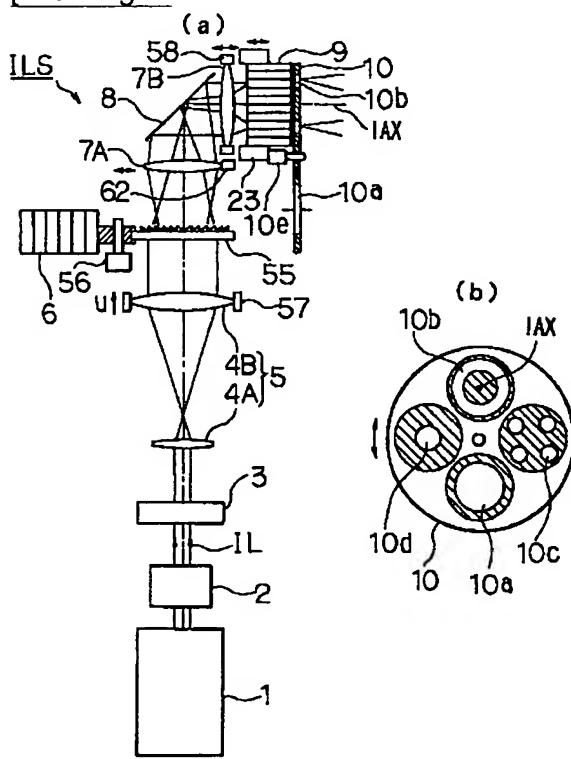


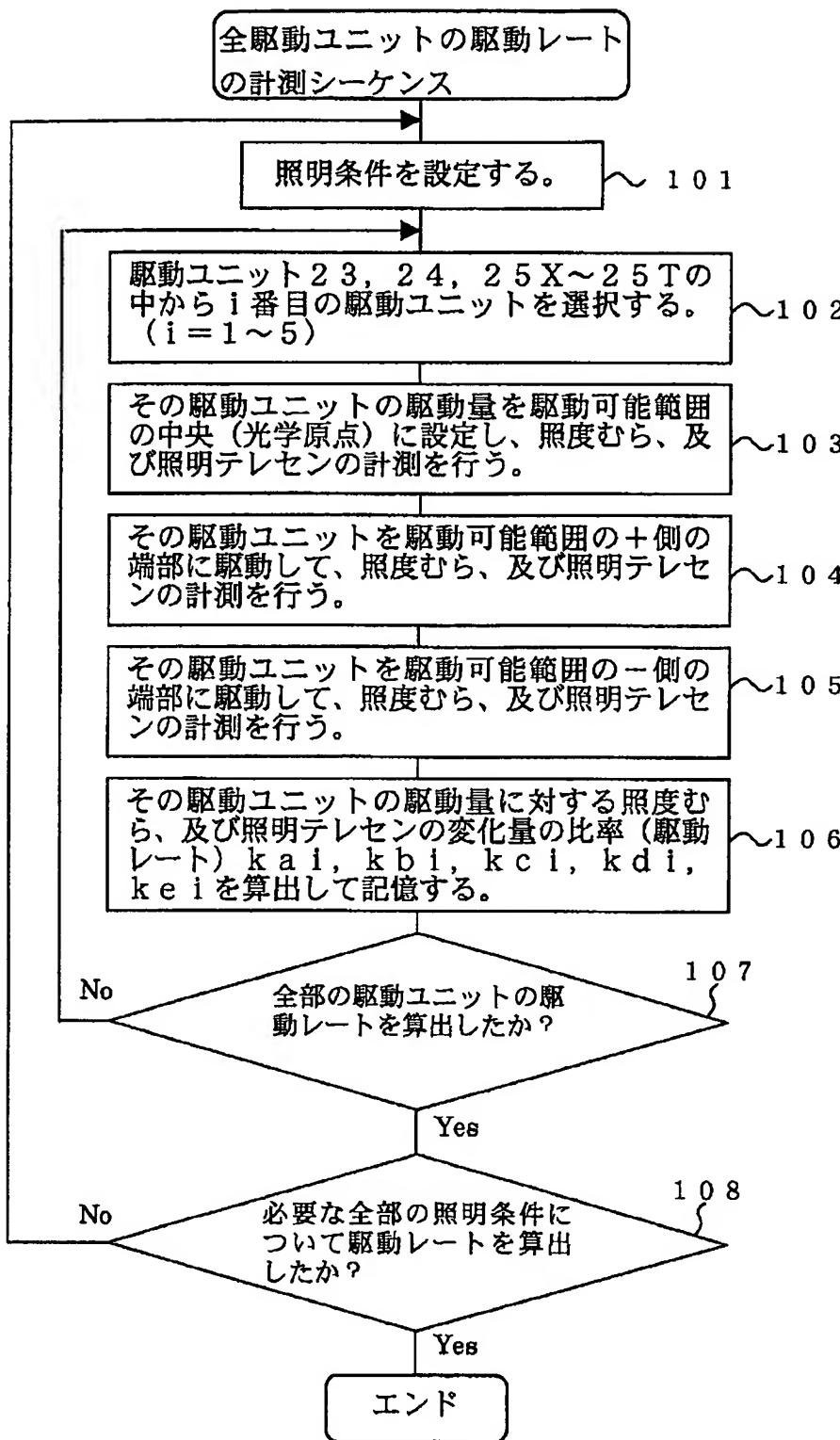
[Drawing 1]



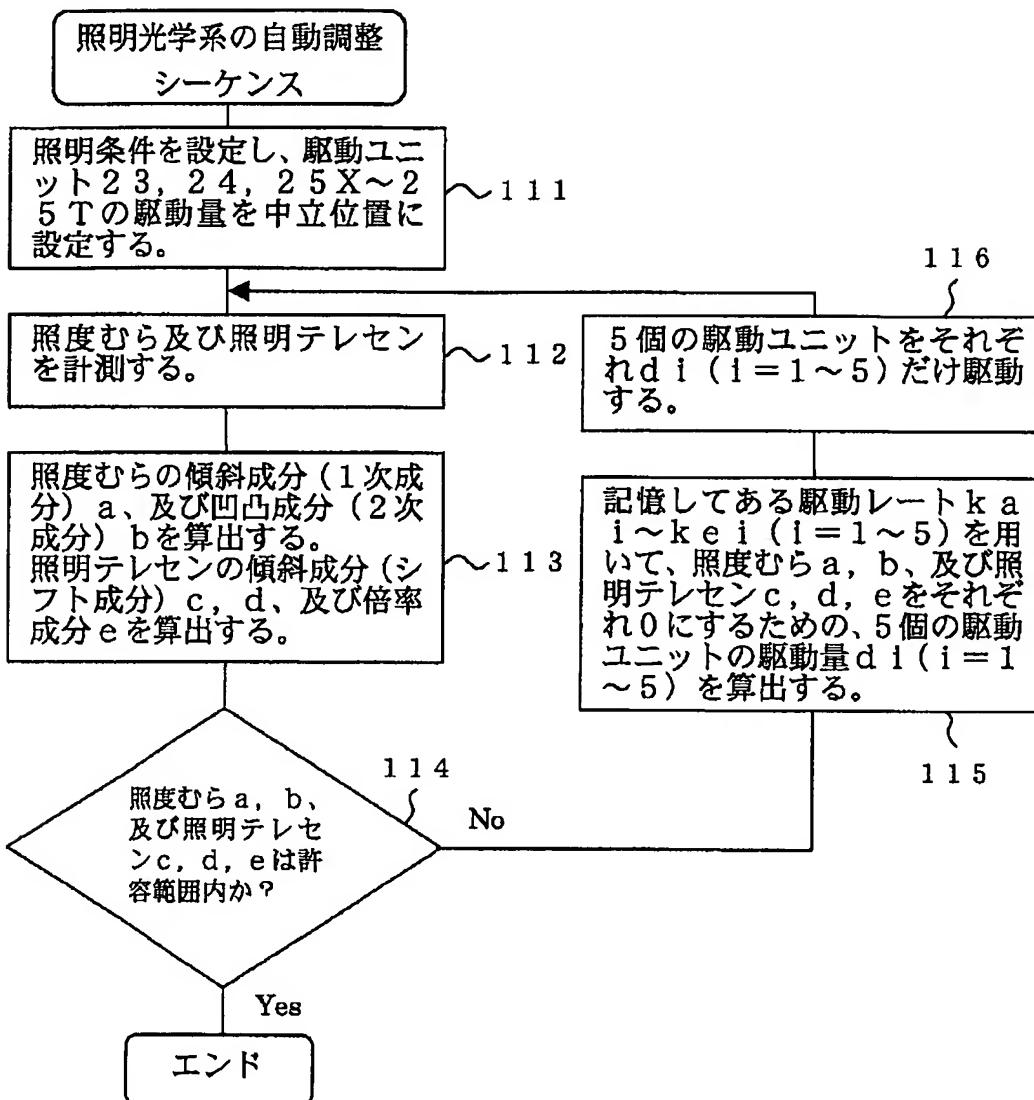
[Drawing 4]



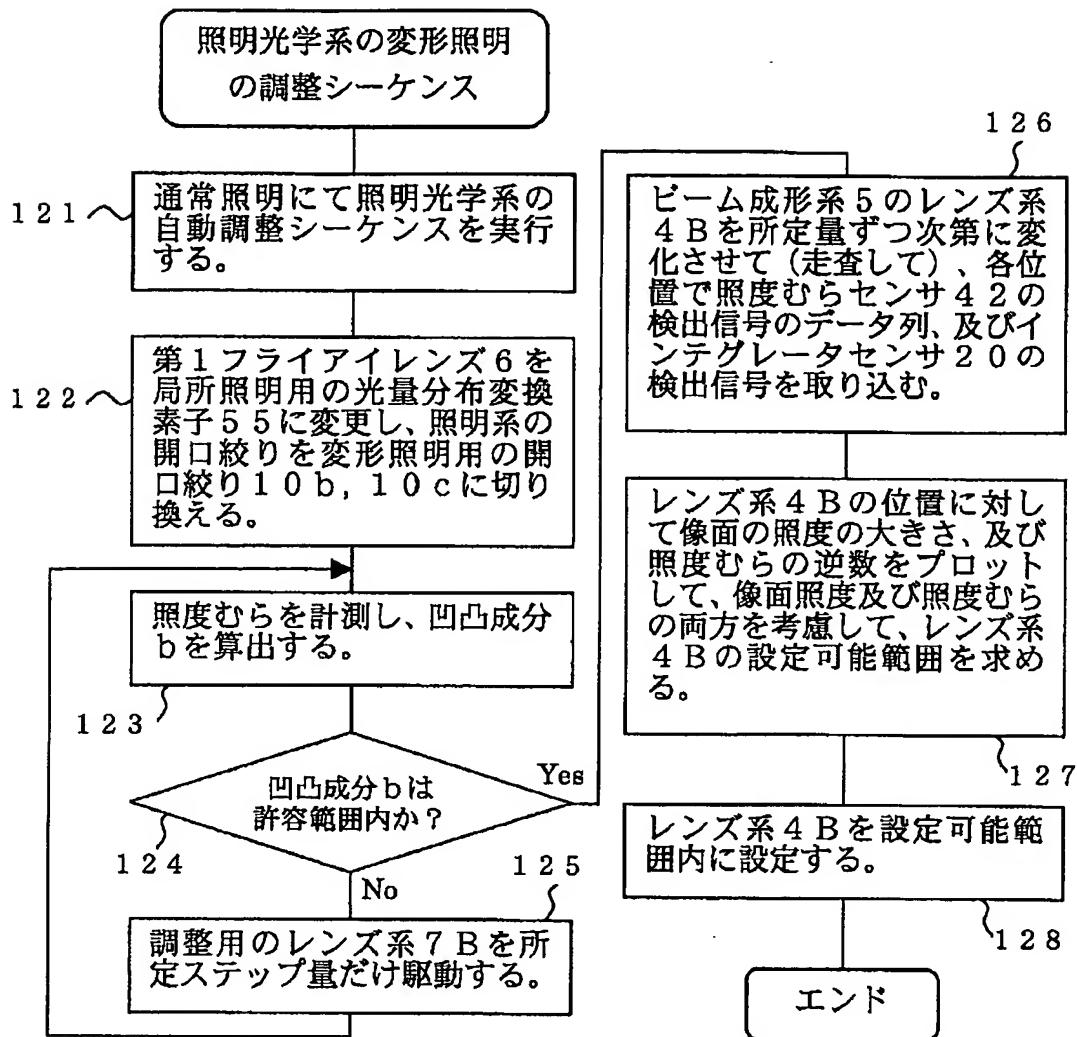
[Drawing 5][Drawing 6][Drawing 8]



[Drawing 9]



[Drawing 10]



[Translation done.]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 露光ビームで第1物体を照明する照明系を備え、前記露光ビームで前記第1物体を介して第2物体を露光する露光装置において、前記照明系中に配置されて、前記露光ビームの照明条件を複数の照明条件の何れかに切り換える照明条件切り換え系と、前記複数の照明条件のそれぞれに応じて前記照明系の所定の照明特性を制御するために、前記照明系中の所定の光学部材の状態を調整する調整系とを設けたことを特徴とする露光装置。

【請求項2】 前記照明特性は、前記露光ビームの照度むら、及び前記露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の少なくとも一方であることを特徴とする請求項1に記載の露光装置。

【請求項3】 前記照明特性は、前記露光ビームの照度むらの傾斜成分及び凹凸成分、並びに前記露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の傾斜成分及び倍率成分であることを特徴とする請求項2に記載の露光装置。

【請求項4】 前記照明系の前記照明特性を計測する特性計測系と、該特性計測系の計測結果に基づいて、前記調整系の駆動量と前記照明特性の変化量との関係を求めて記憶する演算制御系とを有することを特徴とする請求項1、2、又は3に記載の露光装置。

【請求項5】 露光ビームで第1物体を照明する照明系を備え、前記露光ビームで前記第1物体を介して第2物体を露光する露光装置において、前記照明系の所定の照明特性を計測する特性計測系と、該特性計測系の計測結果に応じて前記照明系中の所定の光学部材の状態を調整する調整系とを設けたことを特徴とする露光装置。

【請求項6】 前記照明系は、オプティカル・インテグレータを有し、前記調整系は、前記オプティカル・インテグレータの光軸方向の位置を調整することを特徴とする請求項1～5の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項7】 前記照明系は、前記オプティカル・インテグレータを通過した前記露光ビームを前記第1物体の被照射面、又はこれと共に役な面に導く第1光学系、及び第2光学系を更に有し、前記調整系は、前記オプティカル・インテグレータの光軸方向の位置、前記第1光学系の光軸方向の位置、並びに前記第2光学系の光軸に垂直な方向の位置及びチルト角を調整することを特徴とする請求項6に記載の露光装置。

【請求項8】 前記照明系は、前記露光ビームの照度分布を変形照明用の局所的な領域に設定するための光学素子と、該光学素子からの露光ビームを導く集光光学系と、

該集光光学系からの露光ビームの照度分布を均一化するためのオプティカル・インテグレータとを有し、前記調整系は、前記集光光学系を構成する光学部材の状態を調整することを特徴とする請求項1～7の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項9】 前記照明系は、露光光源からの露光ビームを成形して前記光学素子に導くビーム成形光学系を備え、前記露光ビームの照度の大きさ、及び前記露光ビームの照度分布のばらつきの大きさのバランスが取れるように前記調整系によって前記ビーム成形光学系の状態を調整することを特徴とする請求項8に記載の露光装置。

【請求項10】 露光ビームで第1物体を照明する照明系を備え、前記露光ビームで前記第1物体を介して第2物体を露光する露光装置において、前記照明系における前記露光ビームのテレセントリック性の崩れ量を傾斜成分と倍率成分とに分けて計測することを特徴とする露光装置。

【請求項11】 前記照明系による前記露光ビームの照度むらを傾斜成分と凹凸成分とに分けて計測することを特徴とする請求項10に記載の露光装置。

【請求項12】 前記第1物体が載置される第1可動体と、前記第2物体が載置される第2可動体とを有し、前記第1及び第2可動体を同期駆動する駆動系を更に備え、前記第1物体を介して前記露光ビームで前記第2物体を走査露光することを特徴とする請求項1～11の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項13】 前記第2物体が配置される所定面上で前記露光ビームを検出して、前記露光ビームの照射領域内で前記走査露光時に前記第1及び第2物体が移動される走査方向と直交する非走査方向に関する照度むらの傾斜成分を計測することを特徴とする請求項12に記載の露光装置。

【請求項14】 前記露光ビームの照射領域内で、前記走査方向に関して照度又は光量を積算して得られる、前記非走査方向に関する積算分布に基づいて、前記照度むらの凹凸成分と前記非走査方向に関する傾斜成分とを決定することを特徴とする請求項13に記載の露光装置。

【請求項15】 前記第1可動体上で前記第1物体以外に設けられるマークに照射される露光ビームを検出して、その崩れ量を計測することを特徴とする請求項1～13に記載の露光装置。

【請求項16】 照明系を通る露光ビームを第1物体に照射し、前記第1物体を介して前記露光ビームで第2物体を露光する露光装置の調整方法において、前記第2物体が配置される所定面上で前記露光ビームを検出して、前記照明系のテレセントリシティと、前記露光ビームの照射領域内での照度又は光量の分布との少なくとも一方を含む照明特性を計測すると共に、前記計測された照明特性に基づいて前記照明系内の光学部材を駆

動し、前記照明特性を次に計測するまでは、前記計測された照明特性を計算にて更新すると共に、前記更新された照明特性に基づいて前記光学部材を駆動することを特徴とする露光装置の調整方法。

【請求項17】 前記第1物体が載置される第1可動体と、前記第2物体が載置される第2可動体とを同期駆動して、前記第1物体を介して前記露光ビームで前記第2物体を走査露光し、前記第1可動体上で前記第1物体以外に設けられるマークを用いて前記照明特性を計測することを特徴とする請求項16に記載の露光装置の調整方法。

【請求項18】 前記第2物体が配置される所定面上で前記露光ビームを検出して、前記露光ビームの照射領域内で前記走査露光時に前記第1及び第2物体が移動される走査方向と直交する非走査方向に関する照度むらの傾斜成分を計測することを特徴とする請求項17に記載の露光装置の調整方法。

【請求項19】 露光ビームで第1物体を照明する照明系を備え、前記露光ビームで前記第1物体を介して第2物体を露光する露光装置の調整方法において、前記照明系中の所定の光学部材の状態を複数の状態に設定して、それぞれ前記照明系の所定の照明特性の計測を行い、該計測結果に基づいて、前記光学部材の駆動量と前記照明特性の変化量との関係を求めて記憶し、該記憶された関係に基づいて、前記照明特性を制御するために前記光学部材を駆動することを特徴とする露光装置の調整方法。

【請求項20】 前記照明系の照明条件を複数の照明条件の何れかに切り換えることにしておき、前記複数の照明条件のそれぞれに対して前記光学部材の最適位置を求めて記憶しておき、前記照明系の照明条件が切り換えられた際に、前記光学部材の位置を切り換えた後の照明条件に対する最適位置に設定することを特徴とする請求項19に記載の露光装置の調整方法。

【請求項21】 請求項1～15の何れか一項に記載の露光装置を用いてデバイスパターンをワークピース上に転写する工程を含むデバイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、例えば半導体素子、液晶表示素子、プラズマディスプレイ素子、又は薄膜磁気ヘッド等を製造するためのリソグラフィ工程でマスクパターンを投影光学系を介して基板上に転写するために使用される露光装置、及びこの露光装置の調整方法に関し、特に照明系の調整を自動的に行う機能を備えた露光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 半導体デバイスの集積度及び微細度の向

上に対応するため、半導体デバイスを製造するためのリソグラフィ工程（代表的にはレジスト塗布工程、露光工程、及びレジスト現像工程からなる）を担う露光装置においては、解像力、及び転写忠実度等をより高めることが要求されている。このように解像力、及び転写忠実度を高めるためには、露光ビームとしての露光光の波長を短波長化して、開口数の大きい投影光学系を使用すると共に、基板としてのウエハ上に塗布されたフォトレジストを適正露光量で露光するための露光量制御を高精度に行う必要がある。そして、その投影光学系の結像特性を限界まで引き出して、フォトレジストの露光量制御を高精度に行うためには、マスクとしてのレチクルを露光光で照明する照明光学系の照明特性をできるだけ高めるよう、その照明光学系の最適化を行う必要がある。

【0003】 露光装置の照明光学系を最適化するための調整は、従来は以下のような工程で行われていた。

(イ) オペレータが照明光学系の調整対象の照明特性(例えば照度むら)を計測する。

(ロ) その計測結果に基づいて、その照明特性に対応した駆動ユニットを用いて所定の光学部材の状態(位置又は傾斜角等)を調整する。この際の駆動量は、光学設計値をオペレータの経験に基づいて修正することによって、その照明特性をできるだけ改善するように設定される。

【0004】 (ハ) その調整後に、その照明特性の残存する量を再計測し、その残存する量が許容範囲を超える際には、その駆動ユニットを介して再調整を行う。

(ニ) その調整の完了後に、その光学部材の最終的な状態(最適な状態)を記憶する。

そして、複数の照明条件のそれぞれにおいて、上記の調整工程を調整対象の照明特性毎に繰り返して、対応する光学部材の最適な状態を記憶し、照明条件が切り換えられた際には、対応する光学部材をそれぞれ最適な状態に設定していた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 上記の如く従来の露光装置の照明光学系を最適化するための調整は、露光装置の組立調整時、及びメンテナンス時等にオペレータによって行われていた。しかしながら、オペレータが調整を行う場合には、調整に長い時間を要するという不都合がある。更に、複数の照明条件の全てについてそれぞれ照明光学系の調整を行う必要があるため、全体の調整時間はかなり長くなっていた。また、最適化に要する時間は、オペレータの熟練度にも左右されるため、オペレータによっては更に調整時間が長くなってしまう恐れもあった。

【0006】 また、照明光学系中の複数の光学部材の状態を調整する必要がある場合には、調整に伴う相互の影響等も考慮する必要があるため、調整工程が極めて煩雑となっていた。このように従来の照明光学系の調整には

長時間の煩雑な工程を要したため、例えば製造するデバイスの要求精度等に応じて所定の照明特性の許容レベルを変化させるような運用を行うことが困難であった。また、例えば照明特性中の照度むら等は、照明光学系中の光学部材の曇り、及び硝材の劣化等によって経時に変化する場合があるが、このような場合にも従来の調整方法では迅速に対応することが困難であった。

【0007】本発明は斯かる点に鑑み、照明光学系の調整を短時間に正確に行うことができる露光装置を提供することを第1の目的とする。更に本発明は、複数の照明条件に切り換えることができる照明光学系の調整を実質的に自動的に行うことができる露光装置を提供することを第2の目的とする。

【0008】更に本発明は、そのような露光装置の効率的な使用方法、及びその露光装置を用いた高精度なデバイス製造方法を提供することも目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明による第1の露光装置は、露光ビームで第1物体（R）を照明する照明系（ILS）を備え、その露光ビームでその第1物体を介して第2物体（W）を露光する露光装置において、その照明系中に配置されて、その露光ビームの照明条件を複数の照明条件の何れかに切り換える照明条件切り換え系（10, 10e）と、その複数の照明条件のそれぞれに応じてその照明系の所定の照明特性を制御するために、その照明系中の所定の光学部材（9, 12, 13）の状態を調整する調整系（23, 24, 25）とを設けたものである。

【0010】斯かる本発明によれば、その照明条件切り換え系によって照明条件を切り換えた際には、切り換え後の照明条件に応じてその調整系を介してその光学部材の状態（光軸方向の位置、光軸に垂直な方向の位置、及びチルト角等）を調整する。これによって、複数の照明条件に対してそれぞれ実質的に自動的に照明系の所定の照明特性を所望の状態に制御できる。

【0011】この場合、その評価対象の所定の照明特性の一例は、その露光ビームの照度むら、及びその露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の少なくとも一方である。これらは共にその第2物体上で高い解像度を得るために極めて重要な特性である。更に、その評価対象の照明特性を、その露光ビームの照度むらの傾斜成分及び凹凸成分、並びにその露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の傾斜成分（2次元のベクトル量）及び倍率成分とすることが望ましい。この5つの照明特性の成分は、その照明系中の複数の光学部材を互いに独立に駆動することによって容易にほぼ単独に制御できるため、特に自動化を容易に行うことができる。

【0012】なお、ここでは、露光ビームのテレセントリック性の崩れ量は、照明系（又は照明光学系）のテレセントリシティである。また、その照明系のその照明特

性を計測する特性計測系（33, 46, 42）と、この特性計測系の計測結果に基づいて、その調整系の駆動量とその照明特性の変化量との関係を求めて記憶する演算制御系（22）とを有することが望ましい。その照明特性が経時に変化する場合には、例えば定期的にその特性計測系でその照明特性を計測する、或いは先に記憶した関係を計算（シミュレーション）にて更新する、又は両者を併用する（即ち、定期的な照明特性の計測の間は計算にて上記関係を更新する）と共に、これに基づいてその調整系を駆動することによって、その照明特性を迅速に所望の状態に戻すことができる。

【0013】次に、本発明の第2の露光装置は、露光ビームで第1物体（R）を照明する照明系（ILS）を備え、その露光ビームでその第1物体を介して第2物体（W）を露光する露光装置において、その照明系の所定の照明特性を計測する特性計測系（33, 46, 42）と、この特性計測系の計測結果に応じてその照明系中の所定の光学部材の状態を調整する調整系（23, 24, 25）とを設けたものである。

【0014】斯かる本発明によれば、例えば空間像計測系等を備えたその特性計測系の計測結果に基づいてその調整系を駆動することによって、その照明系の調整を短時間に正確に行うことができる。これらの本発明において、その照明系が、オプティカル・インテグレータ（9）（ユニフォマイザ、又はホモジナイザ）と、そのオプティカル・インテグレータを通過したその露光ビームをその第1物体の被照射面、又はこれと共に面に導く第1光学系（12）、及び第2光学系（13）とを有する場合、これらの光学部材の状態を次のように調整することで、それ以下以下の照明特性を実質的に互いに独立に制御できる。

【0015】（a1）オプティカル・インテグレータ（9）の光軸方向の位置調整：露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の倍率成分、（b1）第1光学系の光軸方向の位置調整：照度むらの凹凸成分、（c1）第2光学系の光軸に垂直な方向の2次元の位置調整：露光ビームのテレセントリック性の崩れ量の傾斜成分（2次元のベクトル量）、（d1）第2光学系のチルト角：照度むらのそのチルトする方向の傾斜成分。そのチルトする方向は、走査露光方式の露光装置の場合には、走査方向に直交する非走査方向に対応することが望ましい。これは走査方向では積分効果によって照度むらが平均化されるのに対して、非走査方向では平均化効果が生じないためにそのチルトによって補正することが望ましいからである。

【0016】また、上記の本発明において、その照明系がその露光ビームの照度分布を変形照明用の局所的な領域に設定するための光学素子（55）と、露光光源からの露光ビームをその光学素子に導くビーム成形光学系（5）と、その光学素子（55）からの露光ビームを導

く集光光学系(7A, 7B)と、この集光光学系からの露光ビームの照度分布を均一化するためのオプティカル・インテグレータ(9)(ユニフォマイザ、又はホモジナイザ)とを備える場合、その調整系は、その集光光学系、又はそのビーム成形光学系の状態を調整することが望ましい。

【0017】この際に、例えばその露光ビームの照度の大きさ、及びその露光ビームの照度分布のばらつきの大きさのバランスが取れるようにそのビーム成形光学系を調整することによって、露光ビームの損失を最小にした上で照度むらを小さくすることができる。また、本発明の第3の露光装置は、露光ビームで第1物体(R)を照明する照明系(ILS)を備え、その露光ビームでその第1物体を介して第2物体(W)を露光する露光装置において、その照明系におけるその露光ビームのテレンントリック性の崩れ量を傾斜成分と倍率成分とに分けて計測するものである。このように傾斜成分と倍率成分とに分けることで、調整をほぼ互いに独立に容易に行うことができる。

【0018】上記の本発明の露光装置において、その第1物体が載置される第1可動体(31)と、その第2物体が載置される第2可動体(39)とを有し、その第1及び第2可動体を同期駆動する駆動系(34, 41)を更に備え、その第1物体を介してその露光ビームでその第2物体を走査露光するようにしてもよい。この場合、その第2物体が配置される所定面上でその露光ビームを検出して、その露光ビームの照射領域内でその走査露光時にその第1及び第2物体が移動される走査方向と直交する非走査方向に関する照度むらの傾斜成分を計測することが望ましい。走査露光を行う場合には、走査方向の照度むらは平均化効果で低減されるため、非走査方向の照度むらを計測することで、計測装置を簡素化できる。

【0019】また、その第1可動体上でその第1物体以外に設けられるマーク(36A)に照射される露光ビームを検出して、その崩れ量を計測するようにしてもよい。これによってその第1物体(マスク等)のパターンに依らずに、必要に応じて照明特性を計測することができる。次に、本発明の第1の露光装置の調整方法は、照明系(ILS)を通る露光ビームを第1物体(R)に照射し、その第1物体を介してその露光ビームで第2物体(W)を露光する露光装置の調整方法において、その第2物体が配置される所定面上でその露光ビームを検出して、その照明系のテレンントリシティと、その露光ビームの照射領域内の照度又は光量の分布との少なくとも一方を含む照明特性を計測すると共に、その計測された照明特性に基づいてその照明系内の光学部材(9, 12, 13)を駆動し、その照明特性を次に計測するまでは、その計測された照明特性を計算にて更新すると共に、その更新された照明特性に基づいてその光学部材を駆動するものである。

【0020】斯かる本発明によれば、その照明特性の計測頻度を少なくして、その照明系の照明特性を短時間に高精度に調整できる。この場合、その第1物体が載置される第1可動体(31)と、その第2物体が載置される第2可動体(39)とを同期駆動して、その第1物体を介してその露光ビームでその第2物体を走査露光し、その第1可動体上でその第1物体以外に設けられるマーク(36A)を用いてその照明特性を計測するようにしてもよい。

【0021】更に、その第2物体が配置される所定面上でその露光ビームを検出して、その露光ビームの照射領域内でその走査露光時にその第1及び第2物体が移動される走査方向と直交する非走査方向に関する照度むらの傾斜成分を計測するようにしてもよい。走査露光方式の場合には、走査方向の照度むらは平均化効果で低減されるため、非走査方向の成分を計測することで、計測工程を簡素化して、必要な照明特性を効率的に計測できる。

【0022】次に、本発明の第2の露光装置の調整方法は、露光ビームで第1物体を照明する照明系(ILS)を備え、その露光ビームでその第1物体を介して第2物体を露光する露光装置の調整方法において、その照明系中の所定の光学部材(9, 12, 13)の状態を複数の状態に設定して、それぞれその照明系の所定の照明特性の計測を行い、この計測結果に基づいて、その光学部材の駆動量とその照明特性の変化量との関係(比率等)を求めて記憶し、この記憶された関係に基づいて、その照明特性を制御するためにその光学部材を駆動するものである。本発明によれば、予めその光学部材の駆動量とその照明特性の変化量との関係を求めておくことで、照明特性を効率的に調整できる。

【0023】また、本発明のデバイス製造方法は、本発明の露光装置を用いてデバイスピターン(R)をワークピース(W)上に転写する工程を含むものである。本発明によって集積度の高いデバイスを高精度に量産することができる。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例につき図面を参照して説明する。本例は、ステップ・アンド・スキャン方式又はステップ・アンド・スティッチ方式の走査露光型の投影露光装置に本発明を適用したものである。図1は、本例の投影露光装置の概略構成を示し、この図1において、露光光源1としてはArFエキシマーレーザ光源(波長193nm)が使用されている。但し、露光光源1としては、KrFエキシマーレーザ(波長248nm)、F₂レーザ(波長157nm)、Kr₂レーザ(波長146nm)、YAGレーザの高調波発生装置、半導体レーザの高調波発生装置、又は水銀ランプ等を使用することができる。露光光源1からの波長193nmの紫外パルス光よりなる露光光IL(露光ビーム)は、露光装置本体との間で光路を位置的にマッチン

グさせるためのビームマッチングユニット（B M U）2を通り、光アッテネータとしての可変減光器3に入射する。ウエハ上のフォトレジストに対する露光量を制御するための露光制御ユニット21が、露光源1の発光の開始及び停止、並びに output（発振周波数、パルスエネルギー）を制御すると共に、可変減光器3における減光率を段階的、又は連続的に調整する。

【0025】可変減光器3を通った露光光I Lは、所定の光軸に沿って配置される第1レンズ系4 A及び第2レンズ系4 Bよりなるビーム成形系5を経て第1段のオプティカル・インテグレータ（ユニフォマイザ、又はホモジナイザ）としての第1フライアイレンズ6に入射する。この第1フライアイレンズ6から射出された露光光I Lは、第1レンズ系7 A、光路折り曲げ用のミラー8、及び第2レンズ系7 Bを介して第2段のオプティカル・インテグレータとしての第2フライアイレンズ9に入射する。第1レンズ系7 A及び第2レンズ系7 Bより集光光学系としてのリレー光学系（又はビーム成形系とも呼ぶことができる）が構成されている。

【0026】第2フライアイレンズ9の射出面、即ち露光対象のレチクルRのパターン面（レチクル面）に対する光学的なフーリエ変換面（照明系の瞳面）には開口絞り板10が、駆動モータ10 eによって回転自在に配置されている。開口絞り板10には、図6（b）に正面図で示すように、通常照明用の円形の開口絞り10 a、変形照明の一例としての輪帶照明用の開口絞り10 b、変形照明の別の例としての変形光源（又はいわゆる傾斜照明）用の複数（本例では4個）の偏心した小開口よりなる開口絞り10 c、及び小さいコヒーレンスファクタ（ σ 値）用の小円形の開口絞り10 dが切り換え自在に配置されている。開口絞り10 cは、4極照明用の開口絞りとも言うことができる。開口絞り板10及び駆動モータ10 eより照明条件を複数の照明条件（通常照明、変形照明、及び小 σ 値照明）の何れかに切り換える「照明条件切り換え系」が構成されており、装置全体の動作を統轄制御する主制御系22が駆動モータ10 eを介して照明条件を設定する。

【0027】図1において、第2フライアイレンズ9の射出面に通常照明用の開口絞り10 aが設置されており、第2フライアイレンズ9から射出されて開口絞り10 aを通過した露光光I Lは、透過率が高く反射率が低いビームスプリッタ11に入射する。ビームスプリッタ11で反射された露光光は、集光用のレンズ19を介して光電検出器よりなるインテグレータセンサ20に入射し、インテグレータセンサ20の検出信号S 1は露光制御ユニット21に供給されている。インテグレータセンサ20の検出信号と被露光基板としてのウエハW上の露光光I Lの照度との関係は予め高精度に計測されて、露光制御ユニット21内のメモリに記憶されている。露光制御ユニット21は、インテグレータセンサ20の検

出信号より間接的にウエハWに対する露光光I Lの照度（平均値）、及びその積分値をモニタできるように構成されている。

【0028】ビームスプリッタ11を透過した露光光I Lは、光軸I AXに沿って第1レンズ系12（第1光学系）及び第2レンズ系13（第2光学系）を経て順次、固定ブラインド（固定照明視野絞り）14 A及び可動ブラインド（可動照明視野絞り）14 Bに入射する。後者の可動ブラインド14 Bはレチクル面に対する共役面に設置され、前者の固定ブラインド14 Aはその共役面から所定量だけデフォーカスした面に配置されている。固定ブラインド14 Aは、例えば特開平4-196513号公報に開示されているように、投影光学系PLの円形視野内で光軸AXをほぼ中心とし、走査露光時にレチクルR及びウエハWが移動される走査方向（Y方向）と直交する非走査方向（X方向）に直線スリット状、又は矩形状（以下、まとめて「スリット状」と言う）に伸びるように配置された開口部を有する。即ち、固定ブラインド14 Aは、本例では露光光I Lが照射されるレチクルR上の照明領域35、及びウエハW上の露光領域35 P（投影光学系PLに関して照明領域35と共に、照明領域35内のパターン像が形成される投影領域）を規定すると共に、少なくとも走査方向に関する幅が固定である開口部を有する。

【0029】更に、可動ブラインド14 Bは、ウエハW上の各ショット領域への走査露光の開始時及び終了時に不要な露光を防止するために、固定ブラインド14 Aによって規定される照明領域35、及び露光領域35 Pの走査方向の幅を可変とするために使用される。可動ブラインド14 Bは、更に走査方向SDと直交した方向（非走査方向）に関してレチクルRのパターン領域のサイズに応じてその幅を可変とするためにも使用される。可動ブラインド14 Bの開口率の情報は露光制御ユニット21にも供給され、インテグレータセンサ20の検出信号から求められる照度にその開口率を乗じた値が、ウエハW上の実際の照度となる。なお、固定ブラインド14 A及び可動ブラインド14 Bはその配置が図1に限定されるものではなく、例えば固定ブラインド14 Aを、レチクルRと照明光学系との間でレチクルRに近接させて配置してもよい。

【0030】露光時に固定ブラインド14 Aを通過した露光光I Lは、光路折り曲げ用のミラー15、結像用のレンズ系16、副コンデンサレンズ系17、及び主コンデンサレンズ系18を介して、マスクとしてのレチクルRのパターン面（下面）の照明領域（照明視野領域）35を照明する。露光光I Lのもとで、レチクルRの照明領域内の回路パターンの像が両側テレセントリックな投影光学系PLを介して所定の投影倍率 β （ β は例えば1/4、1/5等）で、投影光学系PLの結像面に配置された基板（被露光基板）としてのウエハW上のフォトレ

ジスト層のスリット状の露光領域35Pに転写される。レチクルR及びウエハWがそれぞれ本発明の第1物体及び第2物体に対応しており、ウエハ(wafer)Wは例えば半導体(シリコン等)又はSOI(silicon on insulator)等の円板状の基板である。本例の投影系としての投影光学系PLは、ジオプトリック系(屈折系)であるが、カタジオプトリック系(反射屈折系)や反射系も使用できることは言うまでもない。以下、投影光学系PLの光軸AXに平行にZ軸を取り、Z軸に垂直な平面内で走査方向(ここでは図1の紙面に平行な方向)にY軸を取り、走査方向に直交する非走査方向(ここでは図1の紙面に垂直な方向)にX軸を取って説明する。

【0031】図1において、露光光源1、ビームマッチングユニット2、可変減光器3、ビーム形成系5、第1フライアイレンズ6、第1レンズ系7A、第2レンズ系7B、第2フライアイレンズ9、第1レンズ系12、第2レンズ系13、固定ブラインド14A、可動ブラインド14B、結像レンズ系16、副コンデンサレンズ系17、及び主コンデンサレンズ系18等より照明光学系ILSが構成され、照明光学系ILSが本発明の照明系に対応している。そして、照明光学系ILSの光軸ILA Xは、レチクルR上で投影光学系PLの光軸AXと合致している。本例では、第2フライアイレンズ9、第1レンズ系12、及び第2レンズ系13にそれぞれ第1駆動ユニット23、第2駆動ユニット24、及び駆動ユニット群25が装着されている。

【0032】図2は、図1の第2フライアイレンズ9から第2レンズ系13までの光学系と、照明領域35との関係を示す斜視図であり、この図2において、照明領域35に対するレチクルの走査方向SD(Y方向)、及び非走査方向(X方向)に対応する第2フライアイレンズ9上での方向をそれぞれy方向及びx方向としている。そして、第1駆動ユニット23は第2フライアイレンズ9の光軸ILA X方向(矢印A1の方向)の位置を調整し、第2駆動ユニット24は第1レンズ系12の光軸ILA Xの方向(矢印A2の方向)の位置を調整する。また、図1の駆動ユニット群25は、図2の第3の駆動ユニット25X、第4の駆動ユニット25Y、及び第5の駆動ユニット25Tより構成され、駆動ユニット25X及び25Yはそれぞれ第2レンズ系13の光軸ILA Xに垂直なx方向(矢印A3の方向)及びy方向(矢印A4の方向)の位置を調整し、駆動ユニット25Tは、第2レンズ系13の光軸ILA Xを通りy軸に平行な軸の回り(矢印A5の方向)のチルト角を調整する。駆動ユニット25Tは、照明領域35の非走査方向に対応する方向で第2レンズ系13のチルト角(傾斜角)を調整するとも言うことができる。

【0033】駆動ユニット23～25Tとしては、例えば電気式のマイクロメータ、又はピエゾ素子等の駆動素子で駆動対象の光学部材のフランジ部を変位させる駆動

装置を使用することができる。この場合、駆動ユニット23～25Tにはそれぞれ駆動可能範囲(駆動ストローク)内の光学部材の変位量を示すエンコーダ(ロータリエンコーダ等)(不図示)が組み込まれており、これらのエンコーダの検出信号が図1の駆動系26に供給され、その検出信号、及び主制御系22からの駆動情報に基づいて駆動系26は駆動ユニット23～25Tを介して第2フライアイレンズ9、第1レンズ系12、及び第2レンズ系13の状態を制御する。なお、駆動ユニット23～25T用のエンコーダとして、例えば静電容量センサなどを用いてもよい。

【0034】また、本例では変形照明を行う場合に図6(a)に示すように、交換装置56を用いて第1フライアイレンズ6を回折光学素子(Diffractive Optical Element:DOE)よりもなる光量分布変換素子55で交換できるように構成されている。光量分布変換素子55が、露光ビームを局所的な領域に設定するための光学素子に対応している。

【0035】図6(a)において、変形照明を行う場合には、一例として第2フライアイレンズ9の射出面に輪帶状の開口絞り10b(又は4極照明用の開口絞り10c)が設置され、光量分布変換素子55は、回折効果によって露光ILSを第2フライアイレンズ9の入射面のほぼ輪帶状の領域に集光する。光量分布変換素子55も照明光学系ILSに含まれている。これによって、露光光ILSの利用効率が高められて、変形照明を行う場合にもウエハ上で高い照度が得られる。この際に、第2レンズ系7Bの光軸ILA X方向の位置を調整するための駆動ユニット58、第1レンズ系7Aの光軸に垂直な2次元方向の位置を調整するための駆動ユニット62、及びビーム形成系5の第2レンズ系4Bの光軸ILA X方向の位置uを調整するための駆動ユニット57が使用される。電気式のマイクロメータ等から構成される駆動ユニット57、58、62にもそれぞれエンコーダが備えられ、これらのエンコーダの検出信号、及び図1の主制御系22の駆動情報に基づいて、駆動系26が駆動ユニット57、58、62を介して第2レンズ系57、第2レンズ系7B、及び第1レンズ系7Aの状態を制御できるように構成されている。

【0036】なお、第2フライアイレンズ9の入射面上での照射領域(強度分布)が異なる露光ILSを発生する複数の光量分布変換素子(回折光学素子)を交換装置56に設け、照明条件(即ち、照明光学系の瞳面上での露光光ILSの強度分布、本例では照明光路内に配置される複数の開口絞り10a～10dの1つ)に応じて、最も露光ILSの利用効率が高くなる光量分布変換素子を選択して照明光路内に配置するようにしてもよい。このとき、第1フライアイレンズ6を交換装置56に設けなくてもよい。

【0037】図1に戻り、レチクルRは、レチクルステ

ージ3 1上に吸着保持され、レチクルステージ3 1は、レチクルベース3 2上にY方向に等速移動できると共に、X方向、Y方向、回転方向に微動できるように載置されている。レチクルステージ3 1（レチクルR）の2次元的な位置、及び回転角は駆動制御ユニット3 4内のレーザ干渉計によってリアルタイムに計測されている。この計測結果、及び主制御系2 2からの制御情報に基づいて、駆動制御ユニット3 4内の駆動モータ（リニアモータやボイスコイルモータ等）は、レチクルステージ3 1の走査速度、及び位置の制御を行う。また、レチクルステージ3 1のレチクルRの近傍にガラス基板よりなる評価マーク板3 3が固定されている。

【0038】図3 (a) は図1のレチクルステージ3 1を示す平面図であり、この図3 (a)において、レチクルステージ3 1のレチクルRに対して走査方向SD (Y方向)に隣接する領域の開口上に評価マーク板3 3が固定され、評価マーク板3 3のほぼ照明領域3 5と同じ大きさの領域内に、ほぼ均一な分布で一例として13個の2次元の同一の評価用マーク3 6 A, 3 6 B, … 3 6 Mが形成されている。評価用マーク3 6 Aは、X方向に所定ピッチで配列されたライン・アンド・スペースパターンよりなるX軸のマーク3 7 Xと、Y方向に所定ピッチで配列されたライン・アンド・スペースパターンよりなるY軸のマーク3 7 Yとを組み合わせた2次元マークであるが、この他にボックス・イン・ボックスマーク等も使用することができる。本例では、後述のように露光光ILのテレセントリック性の崩れ量、即ち照明光学系のテレセントリシティを計測する際に、レチクルステージ3 1をY方向に駆動して、評価マーク板3 3の中心（評価用マーク3 6 Gの中心）を照明領域3 5の中心（光軸AX）に合わせて、評価用マーク3 6 A, 3 6 B, … 3 6 Mの像を投影光学系PLを介してウエハ側に投影する。評価用マーク3 6 Aの像3 6 APが図3 (b) の拡大図に示されている。

【0039】図1に戻り、ウエハWは、ウエハホルダ3 8を介してウエハステージ3 9上に吸着保持され、ウエハステージ3 9は、ウエハベース4 0上で投影光学系PLの像面と平行なXY平面に沿って2次元移動する。即ち、ウエハステージ3 9は、ウエハベース4 0上でY方向に一定速度で移動すると共に、X方向、Y方向にステップ移動する。更に、ウエハステージ3 9には、ウエハWのZ方向の位置（フォーカス位置）、及びX軸及びY軸の回りの傾斜角を制御するZレベリング機構も組み込まれており、ウエハWの表面の複数の計測点でフォーカス位置を計測するための多点のオートフォーカスセンサ（不図示）も設けられている。露光時には、そのオートフォーカスセンサの計測値に基づいてオートフォーカス方式でZレベリング機構を駆動することで、ウエハWの表面が投影光学系PLの像面に合焦される。また、照明特性の計測時には、一例としてそのオートフォーカスセ

ンサの計測値に基づいて、ウエハステージ3 9内のZレベリング機構を駆動することによって、ウエハステージ3 9の上面のフォーカス位置を任意の量だけ制御することができる。

【0040】ウエハステージ3 9のX方向、Y方向の位置、及びX軸、Y軸、Z軸の回りの回転角は駆動制御ユニット4 1内のレーザ干渉計によってリアルタイムに計測されている。この計測結果及び主制御系2 2からの制御情報に基づいて、駆動制御ユニット4 1内の駆動モータ（リニアモータ等）は、ウエハステージ3 9の走査速度、及び位置の制御を行う。

【0041】主制御系2 2は、レチクルステージ3 1、及びウエハステージ3 9のそれぞれの移動位置、移動速度、移動加速度、位置オフセット等の各種情報を駆動制御ユニット3 4及び4 1に送る。そして、走査露光時には、レチクルステージ3 1を介して露光光ILの照明領域3 5に対してレチクルRが+Y方向（又は-Y方向）に速度Vrで走査されるのに同期して、ウエハステージ3 9を介してレチクルRのパターン像の露光領域3 5 Pに対してウエハWが-Y方向（又は+Y方向）に速度β · Vr (β はレチクルRからウエハWへの投影倍率)で走査される。この際の走査露光の開始時及び終了時に不要な部分への露光を防止するために、駆動制御ユニット3 4によって可動ブラインド1 4 Bの開閉動作が制御される。

【0042】更に主制御系2 2は、ウエハW上の各ショット領域のフォトレジストを適正露光量で走査露光するための各種露光条件を露光データファイルより読み出して、露光制御ユニット2 1とも連携して最適な露光シーケンスを実行する。即ち、ウエハW上の1つのショット領域への走査露光開始の指令が主制御系2 2から露光制御ユニット2 1に発せられると、露光制御ユニット2 1は露光源1の発光を開始すると共に、インテグレータセンサ2 0を介してウエハWに対する露光光ILの照度（単位時間当たりのパルスエネルギーの和）の積分値を算出する。その積分値は走査露光開始時に0にリセットされている。そして、露光制御ユニット2 1では、その照度の積分値を逐次算出し、この結果に応じて、走査露光後のウエハW上のフォトレジストの各点で適正露光量が得られるよう、露光源1の出力（発振周波数、及びパルスエネルギー）及び可変減光器3の減光率を制御する。そして、当該ショット領域への走査露光の終了時に、露光源1の発光が停止される。

【0043】さて、本例のウエハステージ3 9上のウエハホルダ3 8の近傍には、光電検出器よりなりピンホール状の受光部4 2 a（図4 (a) 参照）を有する照度むらセンサ4 2が設置され、照度むらセンサ4 2の検出信号S 2も露光制御ユニット2 1に供給されている。なお、照度むらセンサ4 2はピンホール状の受光部4 2 aの代わりに、或いはそれと組み合わせて、例えば露光領

域35Pに対するウエハWの走査方向(Y方向)に沿って延びる、ラインセンサ或いはCCDなどからなる受光部を用いてもよい。この場合、露光領域35P内で走査方向と直交する非走査方向(X方向)の各位置で、走査方向に関して照度を積算し、この積算値に基づいて非走査方向に関する照度分布を求めてよく、これによって、走査露光による走査方向の照度むらの平均化効果を加味した非走査方向の照度分布(照度むら)、即ち走査露光後のウエハ上での非走査方向に関する露光量分布(露光量むら)を得ることができる。従って、この計測結果を用いて後述する照明特性の最適化(照度むらの補正)を行うようにしてもよい。なお、照度計測時にウエハステージ39を2次元移動することにより、ピンホール状の受光部42aを用いても同様の照度分布を求めることが可能である。

【0044】また、不図示であるが、露光領域35Pの全体を覆う受光部を有する照射量モニタも設置され、この照射量モニタの検出信号とインテグレータセンサ20の検出信号に基づいて、インテグレータセンサ20の検出信号からウエハW上の照度を間接的に求めるための係数が算出される。更に、ウエハステージ39上のウエハホルダ38の近傍には、ガラス基板よりなる走査板43が設置され、走査板43上の遮光膜中にはほぼ正方形の開口パターン43aが形成されている。そして、ウエハステージ39中の走査板43の底面側に集光レンズ44、及び光電検出器45が配置され、走査板43、集光レンズ44、及び光電検出器45より空間像計測系46が構成され、光電検出器45の検出信号S3は露光制御ユニット21内の演算部に供給されている。

【0045】なお、空間像計測系46はその一部(例えば、本例では走査板43と、集光レンズ44などを含む送光系の少なくとも一部とを含む)のみをウエハステージ39に設け、残りの構成要素(光電検出器45など)をウエハステージ39の外部に配置してもよい。また、空間像計測系46は走査板43に1つの開口パターン43aのみが形成され、後述する照明特性の計測時には、ウエハステージ39を2次元的にステッピングさせると共に、照明領域35内に配置される複数(本例では13個)の評価用マークの像の各々に対して、開口パターン43aを走査方向及び非走査方向(Y方向及びX方向)にそれぞれ相対移動するが、例えばその複数の評価用マークと同数の開口パターン43aを走査板43に形成し、走査方向に関する評価用マークの像と開口パターンとの相対移動時と、非走査方向に関する評価用マークの像と開口パターンとの相対移動時にそれぞれその複数の評価用マークの像を一括検出してよい。

【0046】更に、その複数の評価用マークのうち、例えば非走査方向に離れる複数(本例では5個)の評価用マークと同数の開口パターン43aを非走査方向に沿って走査板43に形成し、ウエハステージ39を走査方向

に移動して、各開口パターン毎に、走査方向に配列される各評価用マークの像を連続して検出してもよいし、これとは逆に、走査方向に関して評価用マークと同数の開口パターン43aを走査板43に形成し、ウエハステージ39を非走査方向に移動して、各開口パターン毎に評価用マークの像を連続して検出してもよい。このとき、その複数の評価用マークの検出中に照明領域35の一部のみに露光光ILが照射されるように、ウエハステージ39の移動に応じて可動ブラインド14Bを駆動することが好ましい。なお、前者の方法では非走査方向に関して評価用マークの像と開口パターンとを相対移動するときに、ウエハステージ39を走査方向にステッピングさせる必要があり、後者の方法では走査方向に関して評価用マークの像と開口パターンとを相対移動するときに、ウエハステージ39を非走査方向にステッピングさせる必要があるため、両者を組み合わせて、ウエハステージ39を走査方向と非走査方向とに1回ずつ移動させるだけでもよい。

【0047】例えば図3(a), (b)に示すように、評価用マーク36Aの像36APのY方向の位置を計測する場合には、像36APの手前に走査板43の開口パターン43aを移動した後、ウエハステージ39を駆動して開口パターン43aで像36APを走査する。この際に、露光制御ユニット21には主制御系22を介してウエハステージ39の位置情報も供給されており、露光制御ユニット21内の演算部では、光電検出器45の検出信号をウエハステージ39のX方向の位置に関して微分して得られた信号より、像36APのY方向の位置を算出する。同様に像36APを開口パターン43aでX方向に走査することによって、像36APのX方向の位置も算出され、像36APのX方向、Y方向の位置情報は主制御系22に供給される。

【0048】図1に戻り、レチクルステージ31上の評価マーク板33、ウエハステージ39側の照度むらセンサ42、及び空間像計測系46が、本発明の所定の照明特性(光学特性)を計測する特性計測系に対応している。次に、本例の照明光学系の所定の照明特性を最適化するための調整動作の一例につき説明する。本例では、その所定の照明特性の第1の組として、照明領域35、ひいては露光領域35Pでの露光光ILの照度分布のばらつき(以下、「照度むら」と呼ぶ)、及びレチクルRに対する露光光ILのテレセントリック性の崩れ量(以下、「照明テレンン」と呼ぶ)を選択する。これは、この2つの照明特性が投影光学系PLによる投影像、及びウエハW上のフォトレジストに対して最も大きな影響を与えるためである。

【0049】そして、その照度むらを露光領域35Pの非走査方向(X方向)の位置に関する1次成分(これを「傾斜成分」と呼ぶ)と、その位置に関する2次成分(これを「凹凸成分」と呼ぶ)とに分ける。即ち、照度

を位置Xの関数PF(X)とすると、照度PF(X)は以下のように近似でき、係数aが傾斜成分、係数bが凹凸成分となる。この際に、走査方向(Y方向)の照度むら成分は、走査露光によって平均化されるため、本例で

$$PF(X) = a \cdot X + b \cdot X^2 + \text{オフセット} \quad \dots (1)$$

また、その照明テレンセンを照明領域35(露光領域35P)内での露光光の平均的なX方向、及びY方向への傾斜角に対応する傾斜成分(シフト成分)c, dと、露光光の光軸に対して半径方向に対する平均的な傾斜角に対応する倍率成分eとに分ける。この場合、本例ではウエハステージ39のフォーカス位置を合焦位置に対して±だけデフォーカスさせた位置に設定して、各フォーカス位置で多数の評価用マークの像の位置(ディストーション量)を空間像計測系46で計測し、フォーカス位置の変化量に対する評価用マークの像の平均的なシフト量から傾斜成分c, dを求め、それらの評価用マークの像の半径方向に対する平均的なシフト量から倍率成分eを求めることができる。

【0051】また、本例では図2を参照して説明したように、5個の駆動ユニット23, 24, 25X, 25Y, 25Tを介してそれぞれ第2フライアイレンズ9、第1レンズ系12、及び第2レンズ系13の状態を制御できるが、これらの制御によって以下のように上記の各照明特性をほぼ独立に制御することができる。

(a2) 第1駆動ユニット23による第2フライアイレンズ9の光軸方向の位置調整：照明テレンセンの倍率成分e [mrad]、

(b2) 第2駆動ユニット24による第1レンズ系12の光軸方向の位置調整：照度むらの凹凸成分b [%]、

(c2) 第3駆動ユニット25Xによる第2レンズ系13のx方向の位置調整：照明テレンセンのX方向の傾斜成分c [mrad]、

(c3) 第4駆動ユニット25Yによる第2レンズ系13のy方向の位置調整：照明テレンセンのY方向の傾斜成分d [mrad]、

(d2) 第5駆動ユニット25Tによる第2レンズ系13のチルト角調整：照度むらの非走査方向の傾斜成分a [%]。

【0052】このように本例では、複数の駆動ユニット23～25Tの内の任意の一つの駆動ユニットによって対応する光学部材の状態を制御したときに、実質的にただ1種類の照明特性(光学特性)のみが変化して、他の照明特性は変化しないように状態を制御できる光学部材の組み合わせが最適化されている。これによって、照明特性の自動的な調整を簡単な制御で、かつ高精度に実行することができる。また、駆動ユニットの個数を5個とすることで、基本的な全部の照明特性を自動的に制御することができる。但し、制御対象の照明特性を例えば照明テレンセンのみとするような場合には、駆動ユニットの個数を3個とするなど、制御対象の照明特性に応じて駆

は特に評価対象とはしていない。その凹凸成分は光軸に関して対称な成分(軸対称成分)である。

【0050】

$$\text{動ユニットの個数及び配置は変化する。}$$

【0053】なお、実際には5個の駆動ユニット間で僅かに他の照明特性に対して影響を与える恐れもあるため、他の照明特性に対する影響も考慮することが望ましい。このため、先ず図8のフローチャートに示すように、5個の駆動ユニット23, 24, 25X, 25Y, 25Tを単位量駆動したときに対応する照明特性をどれだけ変化させることができるかを示す駆動レートを求める。

【0054】即ち、図8のステップ101において、図1の開口絞り板10を制御して照明条件を通常照明、変形照明(輪帶照明、若しくは4極照明)、又は小φ値照明の何れかに設定する。次のステップ102において、5個の駆動ユニット23～25T中のi番目(i=1～5)の駆動ユニットを選択する。ここでは第1レンズ系12に対応する2番目の駆動ユニット24を選択したものとする。次のステップ103において、その駆動ユニット24の駆動量d2を駆動可能範囲の中央(d2=0)に設定して、第1レンズ系12を設計上の位置である光学原点に設定した状態で、照度むら、及び照明テレンセンの計測を行う。

【0055】その照度むらの計測を行うために、図1においてレチクルステージ31上にレチクルRの代わりにパターンの形成されていないガラス基板を設置して、照明領域35に露光光ILを照射して、露光領域35Pを照度むらセンサ42の受光部で非走査方向(X方向)に走査して、照度むらセンサ42の検出信号S2を露光制御ユニット21に取り込む。なお、そのガラス基板の代わりに、レチクルRの内のパターンの形成されていない領域、又は評価マーク板33中の評価用マークの形成されていない領域を使用してもよい。

【0056】図4(a)は露光領域35Pを照度むらセンサ42の受光部42aでX方向に走査する状態を示し、図4(b)の曲線51Aは、そのときに照度むらセンサ42(ウエハステージ39)のX方向の位置に対応させてプロットした検出信号S2を示している。本例の露光制御ユニット21内の演算部は、曲線51Aを(1)式の右辺に対して最小自乗法で近似することによって、照度むらの傾斜成分aの値a1、及び凹凸成分bの値b1を算出する。この際のX方向の原点は投影光学系PLの光軸AXとする。曲線51Aを点線で示すように1次の直線52A及び2次曲線53Aに分けた場合、直線52Aの傾きがa1となり、2次曲線53AのX²の係数がb1となる。

【0057】次に、照明テレンセンを計測するために、図

1において、レチクルステージ3 1を駆動して照明領域3 5の中心に評価マーク板3 3の中心を移動して、ウエハステージ3 9を駆動して露光領域3 5 Pの近傍に空間像計測系4 6の走査板4 3を移動する。そして、ウエハステージ3 9内のZレベリング機構を駆動して、走査板4 3のフォーカス位置を投影光学系PLに対する像面(ベストフォーカス位置)から+δだけ(δは所定の解像度が得られる範囲内で予め設定されている)高く設定し、露光光ILの照射を開始して、図5(a)に示すように評価マーク板3 3の評価用マーク3 6 A~3 6 Mの像3 6 AP~3 6 MPをウエハステージ3 9上に投影する。この状態で、図3(b)を参照して説明したように、走査板4 3の開口パターン4 3 aでそれらの像3 6 AP~3 6 MPをX方向、Y方向に走査して、得られる検出信号S 3を露光制御ユニット2 1内の演算部で処理することによって、それらの像3 6 AP~3 6 MPのX方向、Y方向の位置を算出し、算出結果を主制御系2 2に供給する。この場合の原点は、例えば中央の評価用マーク3 6 Gの像3 6 GPの中心である。

【0058】なお、ウエハステージ3 9の移動に応じて可動ブラインド1 4 Bを駆動し、上記検出動作中に照明領域3 5の一部のみ、例えば空間像計測系4 6にてその像を検出すべき評価用マークのみに露光光ILを照射することが望ましい。このように走査板4 3を+δだけデフォーカスさせて計測された評価用マーク3 6 A~3 6 Mの像を図5(a)の点線の格子上の像5 4 A~5 4 Mとする。なお、説明の便宜上、点線の格子は矩形に描かれているが、実際にはディストーションによって或る程度は歪んでいることがある。

【0059】次に、走査板4 3のフォーカス位置をベストフォーカス位置から-δだけ低く設定し、同様に空間像計測系4 6を用いて評価用マーク3 6 A, 3 6 B, …3 6 Mの像3 6 AP~3 6 MPのX方向、Y方向の位置を求めて、主制御系2 2に供給する。図5(a)には、この場合の像3 6 AP~3 6 MP、及び先に計測した像5 4 A~5 4 Mが表示されている。主制御系2 2では、図5(a)に示すように、フォーカス位置を+δだけデフォーカスさせた場合の像5 4 A~5 4 Mに対して、フォーカス位置を-δだけデフォーカスさせた場合の像3

$$k_{a2} = [(a_2 - a_1)/d_{2_{max}} - (a_3 - a_1)/(2 \cdot d_{2_{max}})]/2 \dots (2)$$

【0063】同様にして、照度むらの凹凸成分b、照明テレンセンの傾斜成分c, d、及び照明テレンセンの倍率成分eに対する駆動レートk b 2 [%/mm], k c 2 [mrad/mm], k d 2 [mrad/mm], k e 2 [mrad/mm]も算出されて、主制御系2 2内の記憶部に記憶される。この際に、支配的な値は照度むらの凹凸成分bに対する駆動レートk b 2のみであるが、その他の値でも所定レベルを超えてるものについてはそのまま記憶し、所定レベル内の値については0として記憶してもよい。

6 AP~3 6 MPのX方向、Y方向への2次元的な位置ずれ量をベクトル<VA>~<VM>として求める。また、これらのベクトルの単純な平均値<V1>(=(c1, d1))、及び原点に対して半径方向(R方向)への成分の平均値<V2>(=e1)が図5(b)。

(c)に示すように算出される。平均値(c1, d1)が照明テレンセンの傾斜成分、平均値e1が照明テレンセンの倍率成分である。

【0060】次に、ステップ1 0 4において、その駆動ユニット2 4の駆動量d 2を駆動可能範囲の+側の端部(d 2=d 2_{max})に設定した状態で、照度むら、及び照明テレンセンの計測を行う。これによって、図4(c)に示すように、照度むらセンサ4 2の検出信号S 2の曲線5 1 Bが得られ、この曲線5 1 Bを1次の直線5 2 B及び2次曲線5 3 Bに分けることで、照度むらの傾斜成分a 2、及び凹凸成分b 2が得られる。また、図5(d)の評価用マーク3 6 A~3 6 Mの像3 6 AP~3 6 MPの位置ずれのベクトル<VA>~<VM>から、図5(e), (f)に示すように、照明テレンセンの傾斜成分(c 2, d 2)、及び照明テレンセンの倍率成分e 2が得られる。

【0061】次に、ステップ1 0 5において、その駆動ユニット2 4の駆動量d 2を駆動可能範囲の-側の端部(d 2=-d 2_{max})に設定した状態で、照度むら、及び照明テレンセンの計測を行う。これによって同様に、照度むらの傾斜成分a 3、凹凸成分b 3、及び照明テレンセンの傾斜成分(c 3, d 3)、倍率成分e 3が得られる。なお、更に高精度に駆動レートを算出したい場合には、駆動ユニット2 4の駆動量を4箇所以上に設定して、照度むら及び照明テレンセンを計測することが望ましい。

【0062】その後のステップ1 0 6において、上記の計測値を用いて駆動ユニット2 4(第1レンズ系1 2)の駆動レートを算出する。一例として、駆動量d 2を0, d 2_{max}, -d 2_{max}に設定したときの照度むらの傾斜成分aは、それぞれa 1, a 2, a 3であるため、傾斜成分aに対する駆動レートk a 2 [%/mm]は次のようになる。

$$k_{a2} = [(a_2 - a_1)/(2 \cdot d_{2_{max}}) - (a_3 - a_1)/(2 \cdot d_{2_{max}})]/2 \dots (2)$$

【0064】具体的に第1レンズ系1 2を駆動する場合には、凹凸成分bと同じく中心対称(軸対称)の特性を有する照明テレンセンの倍率成分eに対する駆動レートk e 2が所定レベルを超える可能性がある。このようにして全ての駆動ユニット2 3~2 5 Tについてステップ1 0 2~1 0 6の動作を実行して、駆動レートk a i, k b i, k c i, k d i, k e i(i=1~5)を算出して主制御系2 2内に照明条件毎のパラメータとして記憶する。その後、ステップ1 0 7からステップ1 0 8に移行して、必要な全ての照明条件について駆動レートを算

出したかどうかを判定し、終了していない場合には、ステップ101に戻って照明条件を切り換えて駆動レートを算出する。なお、ここでは全ての照明条件について駆動レートを算出するものとしたが、本例はこれに限定されるものではなく、例えば全ての照明条件の一部のみについて駆動レートを算出し、残りの照明条件については他の照明条件の駆動レートに基づき、補間計算などによって駆動レートを決定するようにしてもよい。

【0065】この際に、第2駆動ユニット24（第1レンズ系12）の場合、中心非対称な成分に関する駆動レート k_{a2}, k_{c2}, k_{d2} は本来は無視できる程度の量である。これらの駆動レートが或る値以上に大きい場合は、第1レンズ系12が偏心していたり、傾いていたりする可能性があり、この段階でこれらの不具合を検知することができ、これに基づいて調整を行うことができる。

【0066】次に、上記のようにして求めた駆動レートを用いて、照明光学系の調整を自動的に行うシーケンスの一例につき図9のフローチャートを参照して説明する。先ず、図9のステップ111において、図1の開口絞り板10を介して照明条件を選択し、全部の駆動ユニット23, 24, 25X～25Tの駆動量を中立位置に設定し、対応する光学部材を光学原点に設定する。次のステップ112において、図8のステップ103と同様に照度むら及び照明テレンセンを計測する。そして、ステップ113において、図4、図5に示した手順で、照度むらの傾斜成分（1次成分）a、凹凸成分（2次成分）bを算出し、照明テレンセンの傾斜成分（ソフト成分）c, d、及び倍率成分eを算出する。次のステップ114において照度むらa, b及び照明テレンセンc, d, eがそれぞれ許容範囲内かどうかを判定し、何れかが許容範囲から外れている場合にはステップ115に移行して、主制御系22内に記憶してある駆動レート $k_{ai}, k_{bi}, k_{ci}, k_{di}, k_{ei}$ ($i = 1 \sim 5$) を用いて、照度むらa, b及び照明テレンセンc, d, eをそれぞれ計算上で0にするための5個の駆動ユニット23～25Tの駆動量 d_i ($i = 1 \sim 5$) を算出する。この場合には、以下の連立方程式を解けばよい。

$$\begin{aligned} [0067] -a &= k_{a1} d_1 + k_{a2} d_2 + k_{a3} d_3 + k_{a4} d_4 + k_{a5} d_5 \\ -b &= k_{b1} d_1 + k_{b2} d_2 + k_{b3} d_3 + k_{b4} d_4 + k_{b5} d_5 \\ -c &= k_{c1} d_1 + k_{c2} d_2 + k_{c3} d_3 + k_{c4} d_4 + k_{c5} d_5 \\ -d &= k_{d1} d_1 + k_{d2} d_2 + k_{d3} d_3 + k_{d4} d_4 + k_{d5} d_5 \\ -e &= k_{e1} d_1 + k_{e2} d_2 + k_{e3} d_3 + k_{e4} d_4 + k_{e5} d_5 \end{aligned}$$

但し、実際には、これらの駆動レート中で0でないものは各行で1個、又は2個程度であるため、この連立方程

式は極めて容易に解くことができる。算出された駆動量 d_i ($i = 1 \sim 5$) も、複数の照明条件のそれぞれに対応させてパラメータとして主制御系22内の記憶部に保存される。

【0068】具体的に、駆動ユニット24と駆動ユニット23とが共に照度むらの凹凸成分bと照明テレンセンの倍率成分eに影響を及ぼし、駆動ユニット25Tと駆動ユニット25Xとが共に照度むらの傾斜成分aと照明テレンセンの傾斜成分cに影響を及ぼし、駆動ユニット25Yのみが照明テレンセンの傾斜成分dに影響を及ぼすという関係があると考えられる。

【0069】次に、ステップ116に移行して、5個の駆動ユニット23～25Tをそれぞれ算出された駆動量 d_i ($i = 1 \sim 5$) だけ駆動する。その後、ステップ112, 113に移行して、照度むらa, b及び照明テレンセンc, d, eを再計測し、ステップ114において、それらの値が全部許容範囲内に収まらない場合には、再びステップ115に移行して計算を実行し、それらの値が全部許容範囲内に収まった場合には自動調整を終了する。そして、次に同じ照明条件が設定された場合には、記憶されている駆動量 d_i に基づいて駆動ユニット23～25Tを駆動するのみで、極めて短時間に照明光学系の調整が完了する。

【0070】このように、本例では照明特性を自動的に計測できるため、図8の駆動レートの計測シーケンス及び図9の照明光学系の自動調整シーケンスは、全てアシストレスで行うことができる。次に、本例の照明光学系で図6(a)に示すように、第2フライアイレンズ9の射出面に輪帶照明の開口絞り10b（又は4極照明の開口絞り10c）を設置して変形照明を行う場合の調整方法の一例につき説明する。

【0071】この場合には、図1の第1フライアイレンズ6の代わりに回折光学素子（DOE）よりなる光量分布変換素子55が設置される。なお、回折光学素子の代わりに円錐プリズム（アキシン、輪帶照明用）、又は四角錐型（ピラミッド型）のプリズム（4極照明用）等のプリズムを使用してもよい。そして、使用される開口絞りが開口絞り10b又は10cの何れかに応じて第2フライアイレンズ9に対する露光光ILの照射領域を調整するために、第1レンズ系7Aを駆動ユニット62によって光軸に垂直な方向に駆動でき、かつ第2レンズ系7Bを駆動ユニット58によって光軸方向に駆動できるようにしておく。なお、レンズ系7A, 7Bよりなる集光光学系（ビーム成形光学系）の代わりに、ズーム光学系、収差を連続的に変化させるような光学系、又はシリンドリカルレンズを回転させてビーム断面を歪ませるような光学系を使用しても良い。

【0072】図6(a)の光学系の場合、第2フライアイレンズ9を局所的に照明する際の照明領域によって、照度むらが急激に変化することが本発明者によって確か

められている。具体的にその照度むらの変化要因は以下の要因に分けられる。

1) 局所照明エリアが小さい場合、開口絞りを通過する光量が多いので像面照度は上昇するが、第2フライアイレンズ9の有効なエレメントのうち幾つかは中途半端に照明され、これが照度むらに悪影響を及ぼす。

【0073】2) 局所照明エリアが大きい場合、照度むらは劣化しないが、当然開口絞り10b, 10cに遮られる光量が多くなり、像面照度は低下する。

3) 局所照明エリアが偏心している場合、像面上の照明むらも左右どちらかが低くなる傾向（傾斜成分）がある。これは第2フライアイレンズ9の各エレメントが有限の大きさを有していることに起因している。よって、本例では光量分布変換素子55を用いて変形照明を行う場合は、図10に示すように特別の調整シーケンスを用意している。

【0074】そこで、図10のステップ121において、図1の状態で、即ち通常照明に設定して、図8の駆動レート計測、及び図9の自動調整シーケンスを実行する。次のステップ122において、図6(a)に示すように、第1フライアイレンズ6を光量分布変換素子55に変更し、第2フライアイレンズ9の射出面の開口絞りを変形照明用の開口絞り10b又は10cに設定する。次のステップ123において、図1の照度むらセンサ42を用いて照度むらを計測し、図4に示したようにその傾斜成分a及び凹凸成分bを算出する。この際に、照度分布の非走査方向の両側に極端な傾斜の照度むらが発生して、傾斜成分aが許容範囲を超えた場合には、前述のように局所照明エリアが偏心している可能性がある。この場合には、その傾斜成分aが許容範囲内に收まるよう、第1レンズ系7Aを光軸に垂直な面内でX方向、Y方向に対応する方向にシフトさせる。

【0075】そして、この状態で照度むらの凹凸成分bを評価対象とする。即ち、ステップ124に移行して、凹凸成分bが許容範囲内かどうかを判定し、許容範囲外であるときにはステップ125に移行して、第2レンズ系7Bを光軸方向に所定ステップ量だけシフトさせてからステップ123に戻って、再び照度むらの凹凸成分bを計測し、それが許容範囲内かどうかを判定する。この補正動作は、ステップ124で凹凸成分bが許容範囲内に收まるまで実行される。

【0076】ステップ124で凹凸成分bが許容範囲内に收まった後、ステップ126に移行して、図6(a)のビーム成形系5のレンズ系4Bを光軸方向に所定量ずつ次第に変化させて（走査して）、レンズ系4Bの各位置（位置u）で図1の照度むらセンサ42をパターン像の無い露光領域35Pで非走査方向に走査して、検出信号S2のデータ列を露光制御ユニット21に取り込むと共に、インテグレータセンサ20の検出信号S1も露光制御ユニット21に取り込む。

【0077】次のステップ127において、レンズ系4Bの各位置uにおいて、検出信号S2（照度）の最大値と最小値との差分△IPを照度むらとして求め、インテグレータセンサ20の検出信号S1より像面での照度の大きさ（平均値）IPを間接的に求める。そして、露光制御ユニット21内の演算部は、レンズ系4Bの各位置uに対して照度むら△IPの逆数（1/△IP）、及び像面照度IPを対応付ける。分かり易いように、位置uに対して像面照度IP及び照度むらの逆数（1/△IP）をプロットした図が図7である。

【0078】図7において、横軸はレンズ系4Bの位置u、縦軸は像面照度IP、及び照度むら△IPの逆数（1/△IP）である。そして、曲線59が像面照度IP、曲線60が照度むらの逆数（1/△IP）を表している。この場合、像面照度IPが大きくなると、照度むらの逆数（1/△IP）が小さくなっていることから、像面照度と照度むらとがトレードオフの関係であることが分かる。そこで、本例では像面照度が許容値TL1（位置u2）以上となり、照度むらの逆数が許容値TL2（位置u1）以上となる位置uの範囲61（u1 ≤ u ≤ u2）を、レンズ系4Bの設定可能範囲として求めて主制御系22に供給する。

【0079】次のステップ128において、図1の主制御系22は駆動系26を介して図6(a)のレンズ系4Bの位置uを設定可能範囲61内に設定する。これによって、高い像面照度が得られて露光工程のスループットを向上できると共に、照度むらが小さくなっている結果精度が得られる。また、像面上で微細なランダムな照度むらが計測される場合は、変形照明用の光学素子を光軸方向にシフトさせれば、ランダムな照度むらを解消させることができる場合がある。以上のように、照明光学系の任意の光学部材を駆動させることにより、各種の照明光学系の特性が変化するが、これらを設計段階で選択し、最適な駆動ユニットを自動調整シーケンスに組み込むことにより、より照度むら及び照明テレンセの追い込み精度を向上させることができる。

【0080】なお、上記の実施の形態では、照度むらとテレンセントリシティとの両方を計測（検出）するものとしたが、どちらか一方を計測するのみでもよい。更に、テレンセントリシティではその傾斜成分をX方向とY方向とに分けて計測したが、どちらか一方のみでもよいことがある。また、上記の実施の形態では走査露光方式の露光装置で非走査方向の照度むらを検出するものとしたが、静止露光方式の露光装置ではX方向及びY方向でそれぞれ照度むらを検出してその補正を行うことが好ましい。

【0081】更に、上記の各実施形態では照明特性（照明テレンセと照度むらとの少なくとも一方）の計測時にその調整を行うものとしたが、その計測時以外に照明特性の調整を行ってもよい。例えば、照明特性の変化を計

算（シミュレーションなど）し、この計算結果に基づいて照明特性を逐次調整してもよい。また、定期的に照明特性を計測してその調整を行うと共に、その定期的な計測の間は上記計算にて照明特性の調整を行うようにしてもよい。更に、照度むらについては照明条件、即ち照明光学系の瞳面上での露光光ILの強度分布（特にその形状）の変更時に照度むらの傾斜成分と中心対称成分（凹凸成分）との両方を調整し、次に照明条件を変更するまでは凹凸成分のみを調整するだけでもよい。

【0082】また、図6(a)では変形照明時に第1フライアイレンズ6との交換で光量分布変換素子55を露光光の光路中に配置するものとしたが、例えば露光源1とオプティカル・インテグレータ（本例では第1フライアイレンズ6）との間にその光量分布変換素子55を配置するようにしてもよい。このとき、照明条件の変更に応じてその光量分布変換素子55を、異なる光量分布を生成する別の素子に交換するようにしてもよい。また、図6(a)の構成例においても、輪帯照明と4極照明とで、光量分布変換素子55を交換するようにしてもよい。

【0083】更に、図1の照明条件切り換え系は、開口絞り板10と、オプティカル・インテグレータ（第1フライアイレンズ6）及び光量分布変換素子（回折光学素子55）の交換を行う交換装置56との両方を含むものとしたが、その照明条件切り換え系は、開口絞り板10のみ、或いは交換装置56のみを含むものでもよいし、交換装置56は前述した複数の光量分布変換素子の交換のみを行なうだけでもよい。更に、開口絞り板10及び交換装置56の少なくとも一方と組み合わせて、或いは開口絞り板10及び交換装置56の代わりに、例えばズーム光学系と、照明光学系の光軸方向に相対移動可能な一対のプリズム（円錐プリズム（アキシコン）、又は四角錐プリズムなど）との少なくとも一方を、露光源1とオプティカル・インテグレータ（第2フライアイレンズ9）との間に配置してもよい。

【0084】なお、上記の実施の形態では、オプティカル・インテグレータとしてフライアイレンズ6、9が使用されているが、オプティカル・インテグレータとして内面反射型インテグレータ（ロッドインテグレータ）を使用する場合も本発明が適用できることは明確かである。更に、上記の実施の形態では2段のフライアイレンズ6、9を用いるいわゆるダブル・フライアイ方式の照明光学系ILSが使用されているが、1段のオプティカル・インテグレータ（フライアイレンズ、ロッドインテグレータ等）のみを用いる照明光学系の調整を行う場合にも本発明を適用することができる。更に、変形照明だけでなく、通常照明や小φ値の照明などでも、前述の回折光学素子（DOE）をオプティカル・インテグレータとして用いてもよい。勿論この場合、複数の回折光学素子を用意して照明条件に応じてその交換を行なうことが望

ましい。

【0085】なお、オプティカル・インテグレータ(9)として、例えば入射面が照明光学系の瞳面に配置され、かつ射出面がレチクルRのパターン面と共に配置される内面反射型インテグレータを用い、かつ露光源1とオプティカル・インテグレータ(9)との間に、前述した複数の光量分布変換素子（回折光学素子）、ズーム光学系、及び一対のプリズムの少なくとも1つを含む光学ユニットを配置する場合、照明条件の変更時に、その内面反射型インテグレータに入射する露光光ILの入射角度範囲が変更されることになる。また、オプティカル・インテグレータ(9)としてフライアイレンズを用いるときはその射出面側に複数の光源像からなる面光源、即ち2次光源が形成され、内面反射型インテグレータを用いるときはその入射面側に複数の虚像からなる2次光源が形成される。従って、上記各実施形態における照明条件の変更とは、照明光学系の瞳面上での露光光ILの強度分布を変更すること、及び照明光学系の瞳面上に形成される2次光源の大きさ及び形状の少なくとも一方を変更することと等価である。

【0086】また、上記の実施の形態は、本発明を走査露光方式の投影露光装置に適用したものであるが、本発明はステップ・アンド・リピート方式（一括露光方式）の投影露光装置（ステッパー）、及び投影系を用いないプロキシミティ方式等の露光装置にも適用することができる。また、露光光（露光ビーム）は上記の紫外光に限られるものではなく、例えばレーザプラズマ光源又はSOR(Synchrotron Orbital Radiation)リングから発生する軟X線領域（波長5~50nm）のEUV光を用いてもよい。EUV露光装置では、照明光学系及び投影光学系はそれぞれ複数の反射光学素子のみから構成される。

【0087】そして、図1のウエハWより半導体デバイスが製造できる。その半導体デバイスは、デバイスの機能・性能設計を行うステップ、このステップに基づいたレチクルを製造するステップ、シリコン材料からウエハを制作するステップ、前述した実施の形態の投影露光装置によりレチクルのパターンをウエハに露光するステップ、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程を含む）、検査ステップ等を経て製造される。

【0088】なお、露光装置の用途としては半導体素子製造用の露光装置に限定されることなく、例えば、角型のガラスプレートに形成される液晶表示素子、若しくはプラズマディスプレイ等のディスプレイ装置用の露光装置や、撮像素子（CCD等）、マイクロマシン、薄膜磁気ヘッド、又はDNAチップ等の各種デバイスを製造するための露光装置にも広く適用できる。更に、本発明は、各種デバイスのマスクパターンが形成されたマスク（フォトマスク、レチクル等）をフォトリソグフィ工程

を用いて製造する際の、露光工程（露光装置）にも適用することができる。

【0089】なお、本発明は上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得ることは勿論である。

【0090】

【発明の効果】本発明によれば、露光装置の照明系（照明光学系）の調整を短時間に正確に行うことができる。また、照明系の照明特性を計測する特性計測系を備えた場合には、複数の照明条件を有する照明系の調整を自動的に行うことができる。また、照明特性として露光ビームのテレンセントリック性の崩れ量（照明系のテレンセントリシティ）の傾斜成分と倍率成分とを分けて計測する場合には、両者を独立に調整することによって調整を短時間に正確に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態の一例の投影露光装置を示す一部を切り欠いた正面図である。

【図2】 図1の第2フライアイレンズ9から第2レンズ系13までの光学系及び照明領域35を示す斜視図である。

【図3】 (a)はレチクルステージ31及び評価マーク板33を示す平面図、(b)は評価用マークの像36APの検出方法の説明に供する拡大平面図である。

【図4】 照度むらの傾斜成分及び凹凸成分の計測方法の説明図である。

【図5】 照明テレンセンの傾斜成分及び倍率成分の計測方法の説明図である。

【図6】 (a)は図1の照明光学系ILSにおいて変形照明を行う場合の要部を示す一部を切り欠いた図、(b)は図6(a)の開口絞り板10を示す正面図である。

【図7】 変形照明を行う場合の照度の大きさと照度むらとの関係の一例を示す図である。

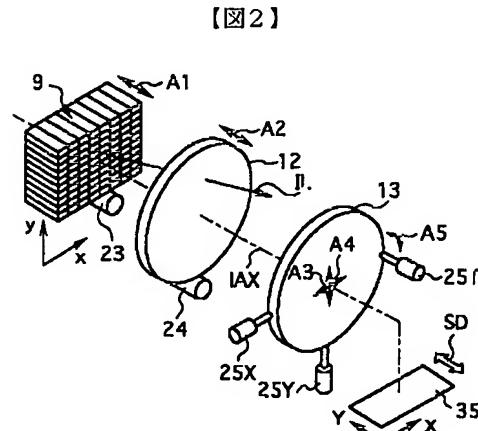
【図8】 照明光学系中の全部の駆動ユニットの駆動レートの計測シーケンスの一例を示すフローチャートである。

【図9】 照明光学系の自動調整シーケンスの一例を示すフローチャートである。

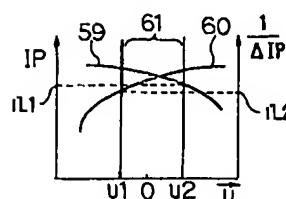
【図10】 変形照明用の調整シーケンスの一例を示すフローチャートである。

【符号の説明】

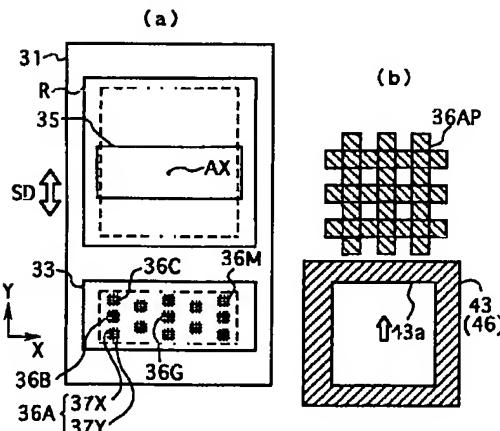
1…露光光源、5…ビーム成形系、6…第1フライアイレンズ、9…第2フライアイレンズ、10…開口絞り板、12…第1レンズ系、13…第2レンズ系、14A…固定ブラインド、R…レチクル、PL…投影光学系、W…ウエハ、20…インテグレータセンサ、21…露光制御ユニット、22…主制御系、23, 24, 25X, 25Y…駆動ユニット、26…駆動系、31…レチクルステージ、33…評価マーク板、36A～36M…評価用マーク、42…照度むらセンサ、46…空間像計測系、55…光量分布変換素子



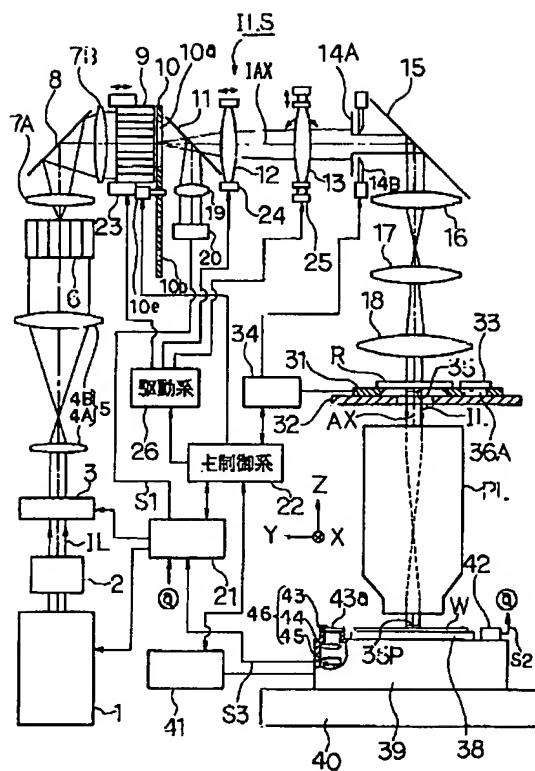
【図7】



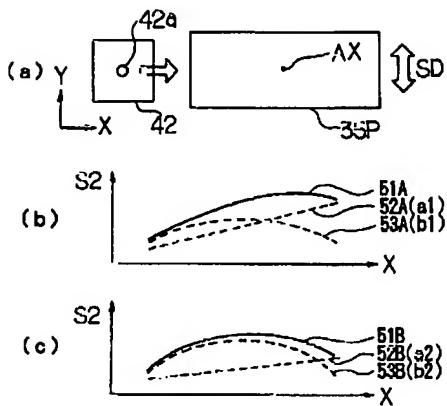
【図3】



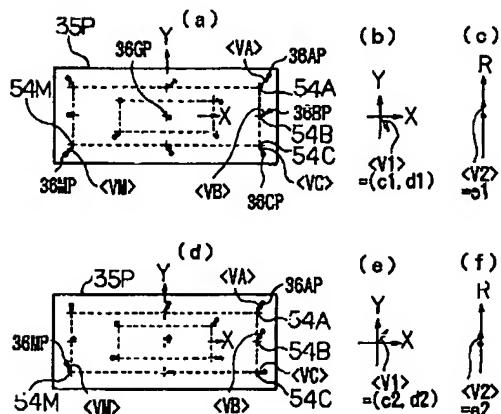
【図1】



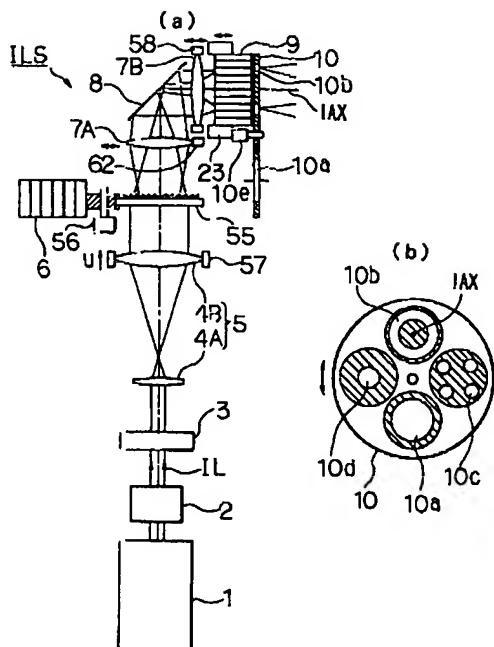
【図4】



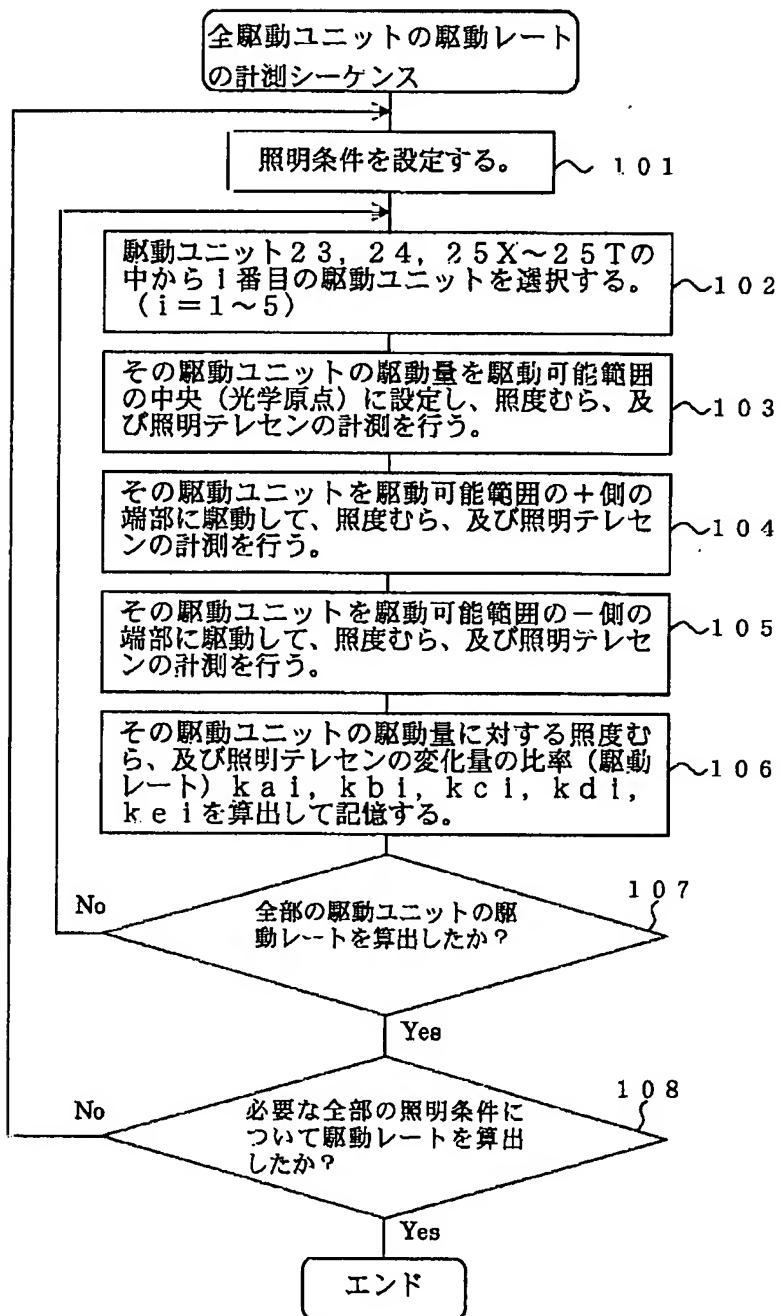
【図5】



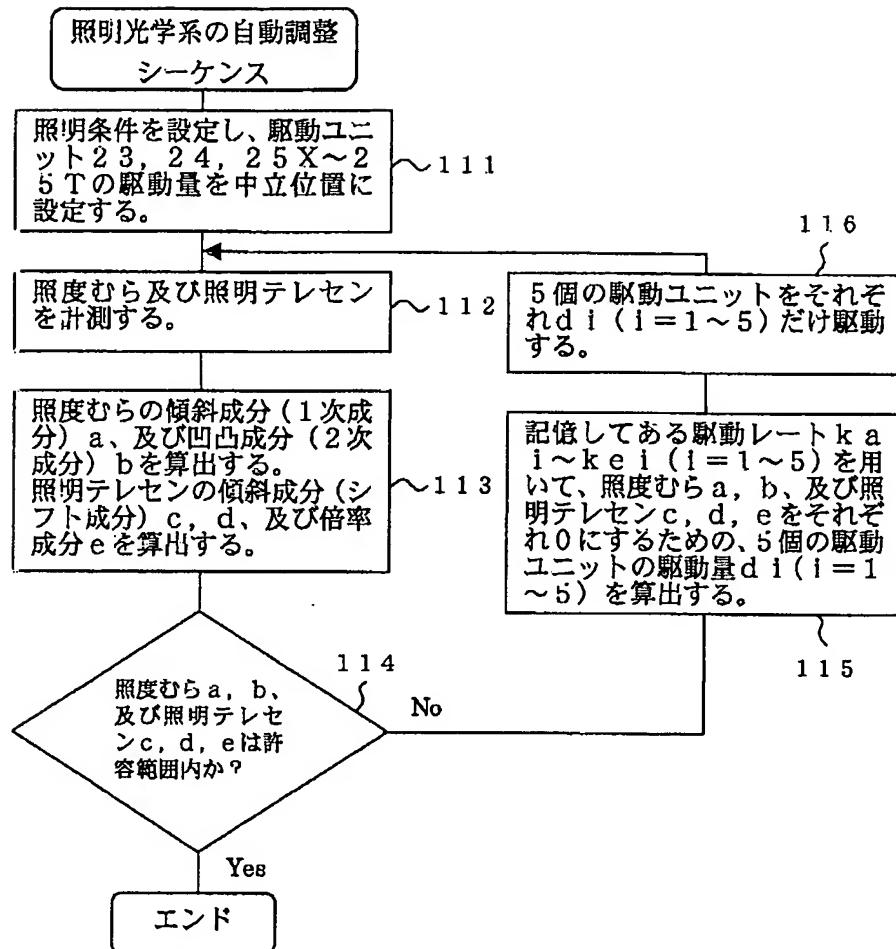
【図6】



【図8】



【図9】



【図10】

